TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ELEKTRİK - ELEKTRONİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ





TÜBİTAK

ÖNSÖZ

TBMMO Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresini ve Sergisini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirmiş olmaktan onur ve sevinç duymaktayız. Üniversite olarak kongreye ikinci kez evsahipliği yapmamız bizi fazlasıyla mutlu etmiştir, ama mutluluğumuz asıl geçen süre içinde Odamızın, meslek yaşamımızın ve Üniversitemizin ne kadar gelişmiş olduğunu gözlemekten kaynaklanmaktadır.

Gerçekten de ilgi alanlarımızın çeşitlenmesi, bu alanlarda belli bir beceriye ulaşılmış olması, eskiden güçlü olduğumuz dallarda da gücümüzün sürmesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendislerimizin ülke genelinde giderek daha fazla söz sahibi olmaları olgusunu yaratmaktadır. Bireysel başarılarımızın kurumlarımızı da ülke ekonomisi ve gelişmesi bakımdan güçlendirmekte olduğu açıktır. Nitekim bu sektörlerde faaliyet gösteren kuruluş sayısı hızla artmaktadır. Bu sayısal gelişmenin nitelik bakımından da aynı hızla sürdüğünü görmek sevindiricidir. Kongremiz ve sergimiz bunun en somut kanıtını oluşturmaktadır.

2000'li yılların Türkiye'sinin ihtiyaçlarını yakalıyabilmek için daha çok şeyler yapılması gerekmektedir. Endüstri-Eğitim Kurumları ve Meslek Odaları arasındaki iletişim ve karşılıklı etkileşimi güçlendirmek gerekmektedir. Bu geçmişe oranla daha sevindirici bir düzeyde sürüyor da olsa henüz gelişmiş ülkelerdeki başardı örneklerin uzağındadır. Önümüzdeki yıllarda bu konuda daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.

Tüm katılımcılara Kongre ve Sergimize vermiş oldukları güç için teşekkür ediyorum. Sizleri Üniversitemizde görmenin kıvancıyla selamlıyor saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Fatih Canatan Yürütme Kurulu Başkam

ELEKTRİK-ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

YÜRÜTME KURULU

Fatih CANATAN (Başkan, ODTÜ)

M. Mete BULUT (ODTÜ) Cengiz BEŞİKÇİ (ODTÜ) Gönül SAYAN (ODTÜ) Cemil ARIKAN (TÜBİTAK) M. Hacim KAMOY (ASELSAN) Hüseyin ARABUL (BARMEK) Aydın GÜRPINAR (ENERSİS) M. Asım RASAN (EMO) Cengiz GÖLTAŞ (EMO) H. Ali YİĞİT (EMO) Kubilay ÖZBEK (EMO) M. Sıtkı Çiğdem (EMO) Funda BAŞARAN (EMO) Mustafa ÖZTÜRK (EMO)

EDİTÖRLER

Fatih CANATAN

Mehmet Mete BULUT

-* · Ulusal Kongra f/1-10 SCKJ-?Q (296-326)

MİKROŞERİT HATLAR İÇİN ISIL GÜRÜLTÜ GÜCÜ ANALİZİ

Tayfun GÜNEL istanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 80626, Maslak, İSTANBUL

ABSTRACT

Thermal noise is a fundamental limitation to the capability of a sensor system for detecting targets. In radar applications, the maximum detection range decreases while the noise power increases. Therefore, this results in a decreased maximum detection range The most troublesome îom of naturally - occuring noise is the thermal noise that is produced by the random motion of atomic particles. In this work, thermal noise analysis of microstrip lines is oresented A numerical example is also given.

GİRİŞ

Atomik parçacıkların rastlantısal hareketi ile meydana gelen ısıl gürültü sıcaklığın bir fonksiyonudur. Gürültü ; direnç, kuvvetlendirici karıştırıcı gibi devre elemanları ve güneş ile uzak galaksilerin radyasyonunun sebep olduğu atmosferdeki elektrik yüklerinin rastlantısal hareketi nedeniyle anten icin de söz konusudur. Anten, anten ile alıcı arasındaki transmisyon hattı ve alıcı birer gürültü kaynağıdırlar. Örneğin radar gürültü gücünün artması isaret uygulamalarında, ve radar menzilinin azalması gürültü oranının anlamına gelmektedir. Modern radar ve uvdu alıcılarında sistem duyarlığının düzeltilmesi için düşük gürültülü kuvvetlendiriciler kullanılır. Alıcı gürültüsü literatürde geniş olarak incelenmiştir. Isıl gürültü en etkin gürültü türlerinden biridir. Bu gürültü çeşidi teorik olarak Nyquist[1], deneysel olarak da Johnson[2] tarafından incelenmiştir. Isıl gürültü, kayıplı çok kapılılar tarafından oluşturulur. Mikroşerit hatlar, günümüzde mikrodalga haberleşme devrelerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu nedenle mikroşerit hatların gürültü özelliklerinin belirlenmesi mikrodalga haberleşme devrelerinin performansının bakımından oldukça önemlidir. Özellikle tahmini MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) yapısındaki haberleşme devrelerinin bilgisayar destekli tasarımında, devre elemanlarının etkileri detaylı bir biçimde incelenmelidir. Tasarımda yapılacak bir yanlışlık ya da ihmal üretim maliyeti bakımından büyük kayıplara neden olabilir. Mikrodalga haberleşme devrelerinin tasarımında gürültü önemli bir parametredir. Bu nedenle tüm elemanların gürültü

etkileri dikkate alınmalıdır. Literatürde genellikle aktif elemanlar için gürültü incelemesi yaygındır Pasif bağıntılar verilmektedir elemanlar için yaklaşık mikrodalga haberleşme devrelerinin çok Ovsaki kullanılan elemanlarından biri olan mikroşerit hatlar icin de detaylı bir gürültü analizi oldukca önemlidir. Bu tür hatların etkisi dikkate alınmaksızın yapılacak analizi tasarımcıyı hatalı bir aürültü sonuca vönlendirebilir. Bu çalışmada, gürültü korelasvon matrisi kullanılarak, kayıplı mikroserit hatların ısıl gürültü gücü analizinin nasıl yapılabileceği bir örnekle aösterilmistir

TEORİ

Isıl bir gürültü kaynağının birim band genişliği başına gücü $p_n(f)$, Boltzman sabiti k (1.3806 10^{23} Joule/K) ve kaynağın mutlak sıcaklığı T ' nin çarpımına eşittir. [3]

$$p_n(f)=kT$$
 Watts/Hz (1)

T sıcaklığındaki bir direncin etkin gürültü sıcaklığı:

$$T_e = p_n / k \tag{2}$$

Gürültü faktörü F ile etkin gürültü sıcaklığı arasındaki bağıntı [4]:

$$F=1+T_{a}/290$$
 (3)

biçimindedir. Kayıplı bir transmisyon hattının gürültü faktörü, transmisyon hattının S-parametreleri ile gürültü korelasyon matrisi $[C_s|$ nin elemanları Csıı, C_si2 ve C_s22 ve kaynak kapısının yansıtma katsayısı p_s kullanılarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir [5]:

$$F = l + \frac{C_{s11} \left| \frac{S_{21}\rho_s}{1 - \rho_s S_{11}} \right|^2 + C_{s22} + 2\text{Re} \left\{ C_{s12} \frac{S_{21}\rho_s}{1 - S_{11}\rho_s} \right\}}{\left(\cdot \left| A \right|^2 \right) \left| \frac{S_{21}}{1 - S_{11}\rho_s} \right|^2}$$
(4)



ŞEKİL: 1. Transmisyon hat parçası.

Transmisyon hattının S-parametreleri [5]:

$$-{}^{s} II - {}^{s} 22 \quad " \frac{Z \overline{v} - Z}{Z_{o}^{2} + Z^{r}}; + 2Z_{o}, Z_{v} \text{ coth} \#$$
(5)

$$S_{1} = S_{1} = \frac{2Z_{0}Z_{v} - esc - h\hat{u}}{Z_{0}^{*} + Z_{0}^{*} - Z_{v} \cosh \theta}$$
(6)

Şekil 1 deki kayıplı transmisyon hattının gürültü korelasyon matrisinin elemanları [5]:

$$\mathbf{C}_{\mathbf{n}} = \mathbf{C}_{\mathbf{y}} \mathbf{r}^{2} \frac{4Z_{0}Z_{N}^{\dagger}(Z_{0}^{2} + Z_{N}^{2})\operatorname{Re}(\operatorname{cuth}(t) + Z_{0}Z_{N}[\operatorname{cuth}(t)^{2} - \operatorname{cuth}(t)^{2}]_{1}^{4}}{(Z_{0}^{2} + Z_{N}^{2})[(Z_{0}^{2} + Z_{N}^{2}) + 4Z_{0}Z^{\wedge} \operatorname{Rejodhtfi}]}$$
(7)

$$C_{y12} = C_{y21} = \frac{4Z_{y}Z_{y}J(Z_{y};-Z_{y}^{*})\text{Re\{coth(9)\}}}{(Z_{y}^{2} + Z_{y}^{2})\left[(Z_{y}^{2} + Z_{y}^{2}) + 4Z_{y}Z_{y}\text{Re}[coth0]\right]}$$
(8)

Yukarıdaki bağıntıda gürültü korelasyon matrisi ile dağılma matrisinin elemanlarının değerleri hat kayıplarının ve frekansın bir fonksiyonudur Şekil 2 de gösterilen mikroşerit hatlarda zayıflama kaybı, iletkenlik kaybı ve dielektrik kayıplarından oluşmaktadır. Birim uzunluk için iletkenlik kaybı a_c (db/birim uzunluk) [6]:

$$\alpha_{L}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h} < D \\ \frac{1.38 \frac{R_{c}}{hZ_{c}} \frac{32 - (\frac{11}{h})^{2}}{32 + (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h})^{2}} A & (\frac{W}{h})^{2} A$$

Yukarıdaki bağıntıda R_{se} efektif yüzey direncini, h mikroşerit hattın yüksekliğini, Z_{o} hattın karakteristik empedansını, I:_e(f) frekansın fonksiyonu olarak efektif dielektrik sabitini, W_{e} ise efektif hat genişliğini göstermektedir A'nın değeri ise W hat genişliği ve t iletken kalınlığı için aşağıdaki bağıntı kullanılarak bulunur.

Hattın W_a/h değeri:

$$\frac{We}{h} = \begin{cases} W \underbrace{125t}_{-+--(1+\ln n)} & W \underbrace{1}_{-+--(1+\ln n)} & \leq \\ P \underbrace{125t}_{-} \underbrace{7} \underbrace{7} \underbrace{7} & P \underbrace{1}_{-} \underbrace{7}_{-} \underbrace$$

Yüzey ve efektif yüzey dirençleri:

$$R_{s} = \sqrt{\pi f \mu_{o} / \sigma} \tag{12}$$

$$/?_{w} = /?_{s} \frac{\left[1 + \frac{2}{T} \tan^{-1} \left[1.4(\frac{5}{\delta})^{2}\right]\right]}{1.4(\frac{5}{\delta})^{2}}$$
(13)

Yukarıdaki bağıntıda I yüzey pürüzlülüğünü göstermektedir.

Cidar kalınlığı:

· · ·

$$\ddot{o} = \frac{2}{(\omega\mu_o\sigma)}$$
(14)

 $2 \le f_{r_r} s$ 16, 0.06 s W/h \le 16, ve f s 100 GHz için efektif dielektrik sabitinin frekansla değişimi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır [6]:

$$\omega_{\rm re}(f) \approx \left(\frac{\sqrt{\varepsilon_r} - \sqrt{\varepsilon_{rc}}}{1 + 4/\epsilon^{-1/5}} + \sqrt{\varepsilon_{rc}}\right)^2 \tag{15}$$

/ukarıdaki bağıntıda F ve ı;,, sırasıyla:

$$F = \frac{4h\sqrt{v_r - 1}}{\lambda_0} \left[0.5 \times \left[1 + 2\log(1 + \frac{11}{h}) \right] \right]$$
(16)



bağıntılarından bulunur. Bu bağıntılardaki H ve G :

$$\frac{1}{i} \frac{4}{i}, j \frac{47}{i}, {\tilde{i}} \frac{5}{i}$$

$$\frac{1}{i} \frac{47}{W}, j \frac{5}{i} \frac{5}{i}$$
(18)

$$G = \frac{\mathbf{r}}{L} 1 - \frac{\mathbf{l} \mathbf{0} /, \mathbf{l}}{ir} \mathbf{J} - \mathbf{0}$$
(19)

 Z_{o} ve s, ' nin fonksiyonu olarak W/h [7]:

1

$$\frac{W}{h} = \begin{cases}
\frac{8e^{i}}{e^{2^{4}} - 2} & A > \sqrt{i}i \\
\frac{2}{1} & B - \sqrt{-hi2B} - \sqrt{+^{L}} \cdot \left(\ln(B-1) + (13) - \frac{00i}{\epsilon_{i}} \right) & A \le L\overline{2}
\end{cases}$$
(20)

Yukarıdaki bağıntıda A ve B nin değerleri sırasıyla

$$\mathcal{A} = \frac{Z_{i}}{60} \left(\frac{\xi_{i} + 1}{2} \right)'_{-} + \frac{\mathfrak{b}_{i} - 1}{c_{r} + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{L_{r}} \right)$$
(21)

$$B = \frac{60 \pi^{-2}}{Z_{v} \sqrt{\varepsilon_{v}}}$$
(22)

bağıntılarından hesaplanır.



ŞEKİL:2 Mikroşerit hat

Birim uzunluk başına dielektrik kaybı $a_{\rm d}$ (db/birim uzunluk):

$$\alpha_{cf} = 27.3 \frac{\varepsilon_r}{\sqrt{\varepsilon_r}(f)} \frac{\varepsilon_{rc}(f)}{\varepsilon_r - 1} \frac{\tau_{rc}}{\lambda_b}$$
(23)

Yukarıdaki bağıntıda tan8 dielektrik malzemenin kayıp tanjantını, X_o ise boşluktaki dalga boyunu, e_r ise bağıl dielektrik sabitini göstermektedir. Toplam kayıp, iletken ve dielektrik kayıplarının toplamına eşittir. Belirli bir uzunluktaki mikroşerit hat için yukarıdaki bağıntılar kullanılarak hesaplanacak olan iletken ve dielektrik kayıplarına bağlı olarak belirlenecek olan gürültü korelasyon matrisi ve S-parametreleri yardımıyla hattın gürültü faktörü bulunur. Bu değer frekansın da fonksiyonudur. Gürültü faktörünün değeri (3) numaralı bağıntıda kullanılarak etkin gürültü sıcaklığı, (2) numaralı bağıntıdan da birim band genişliği başına ısıl gürültü gücü dBW cinsinden hesaplanır.

SONUÇ

Bu çalışmada gürültü korelasyon matrisi kullanılarak, kayıplı bir mikroşerit hattın ısıl gürültü güç yoğunluğu analizi yapılmıştır, örnek olarak seçilen hattın parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. $p_s=0$ için 100 Ghz' lik bir band içinde 1-101 GHz aralığında iki farklı iletkenlik değeri için elde edilen sonuç Şekil 3 de gösterilmiştir. Benzer analiz, parametreleri belirli diğer hatlar için de yapılabilir. Böylece en etkin gürültü türlerinden biri olan ısıl gürültünün etkisi belirlenebilir ve düşük gürültülü mikrodalga alıcı devrelerinin önemli devre elemanlarından biri olan mikroşerit hatların ısıl gürültü etkisi de tasarımda dikkate alınmış olur.

TABLO: 1 Mikroşerit hat parametreleri.

Bağıl dielek. sb.			
Er	9.8		
Taban yüksekliği			
h(m)	0.635X10" ³		
iletken kalınlığı			
t (m)	15X10^		
iletkenlik	o, =5.8X10'		
a (<u>S</u> /m)	a ₂ =1.15X10 ⁷		
Hat uzunluğu			
/(m)	_10X10" ³		
Yüzey pürüzlülüğü			
A(m)	2X10" ⁶		

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ





KAYNAKLAR

- [1]H.Nyquist, "Thermal agitation of electric charge in conductors", Physical Rewiev, Vol.32, pp.100, 1928.
- [2]J.B. Johnson, "Thermal Agitation of electricity in conductors", Physical Rewiev, Vol.32, pp.97, 1928
- [3]R.LFreeman, Radio system design for telecomunications (1-100 GHz), John Wiley & Sons, 1987.
- [4]F.R.Connor,Noise,Thomson Litho Ltd, Scotland.1982
- [5]J.A. Dobrowolski, Introduction to Computer Methods for Microwave Circuit Analysis and Design, Artech House, Chp.5, 1991.
- [6] P.Bhartia.I.J.Bahl, Milimetervvave Engineering and Applications, John Wiley & Sons, 1984.
- [7] K.C.Gupta, R.Garg, R.Chadha, "Computer-Aided Design of Microwave Circuits", Artech House, Dedham, MA, 1981.

Düzgün-Eksenel Bakışımsız Levhada Dalga Yayınımı Yansıma ve Geçirme Katsayıları

S.UÇKUN.G.ÖĞÜCÜ Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 27310-GAZİANTEP

ABSTRACT

A chiral medium is a subelass of bi-anisotropic media. And a special type of bianisoropic media is an axially chiral uniaxial medium. Plane wave reflection and transmission from uniaxial chiral interface have recently been found. In this study, the propagation of the electromagnetic vvaves through an infinite slab of lossless uniaxial chiral medium is formulated for normal incidence, and an eçuation for the total transmission dyadic coefficient is deriven.

ÖZET

Bakışımsız, simetrisiz (chiral), ortam ikili-yönbağımsız (bi-anisotropic), ortamın bir alt sınıfıdır, ikiliyönbağımsız ortamın özel bir durumu ise düzgüneksenel (unıaxial) bakışımsız ortamdır. Düzlemsel elektromagnetik dalganın düzgün-eksenel yüzeyden yansıma ve geçirgenliği kısa süre önce incelenmişti. Bu ça'ışmada kayıpsız düzgün-eksenei bakışımsız, bir levhaya dik gelen dalganın yayınımı, levhadan yansıma ve geçirme katsayıları, sınır koşulları göz önüne alınarak, incelenip yansıma ve toplam geçirgenlik katsayıları matns (dyadic) şeklinde elde edildi

GIRIŞ

Elektromagnetik dalgaların bakışımsız, simetrisiz, ortamlardaki davranışları 19. yüzyılın başından beri bilinmekte ve incelenmektedir[^]] Doğada bulunan bazı kristal, biyolojik yapılar ve sıvıların doğrusai poiarize bir ışığı değişik oranlarda döndürerek ilettiği görülmüş, bu olay optik etki (opticai activity) ve maddeler de bakısımsız (chiral) maddeler diye tanımlanmıştı. lşığın bakışımsız maddelerdeki dönüşümünün maddenin geometrisinden geldiğini anlayan bilim adamları ışık için oluşan optik etkinin daha düşük frekanslar içinde olabileceğini fakat bu durumda bakışımsız küçük mo'fikülierin yerme çok bakışımsız parçacıkların kullanılması gerektiğini düşündüler. Kaynak [2] de verildiği gibi 1920 de Lindman, 1945 de Pickering ve Kaynak [3] de verildiği gibi 1991 de Umarı ve arKadaşları deneysel olarak bakışıms!7 moleküllerin yerine geçecek çok küçük sp:ral iletkenleri yada bakır yaylan bsr yalıtkanın içme gelişigüzel yerleştirerek optik etkmm mikrodalga içinde geçerli olabileceğini gösterdiler. Genelde bakışımsız ortam denildiğinde

$$D = EE + jyB$$
(1)

$$H = jyE + (1 / [A]B$$
(2)

yapı denklemleri ile tanımlanan yönbağımsız (isotropic) bakışımsız ortam anlaşılmaktadır. Burda e,m ve g katsayıları gerçek değerleridir. Ancak bu yönbağımsız bakışımsız ortam yönbağımlı bakışımsız ortamın özel bir durumudur *Düzgün-eksenel* (uniaxial) bakışımsız ortam ise yalıtkan içerisine yerleştirilen spirallerin gelişigüzel yerine Şekil 1 de görüldüğü gibi bir eksene, bu örnekte x ekseni, paralel olarak yerleştirilmesi ile elde edilir.



ŞEKİL: 1 Düzgün-eksenel bakışımsız ievha. Düzgüneksenel levhanın ekseni x ekseni ve sınır yüzeylere paraleldir.

Bu durumda yapı denklemleri

1)
$$-c \cdot E - yy y , /; K \cdot H$$
 (3)

$$Ii = fi \cdot H + \bigvee juj; , , \mathbf{v} \cdot E$$
(4)

ile gösterilip burda d a m parametreleri.

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

$$e = E, \{a_{y}a_{y} + a_{z}a_{z}\} + E fi_{x}a_{x}$$
(5)
=
$$P = /i, (a_{y}a_{z} + a_{z}a_{z}) + \mu_{x}a_{x}a_{x}$$
(6)

$$\kappa = \kappa n_{\rm ex} \tag{7}$$

matris, şeklinde olacaktır. Lindell ve Sihvola [4] hava ve yarı sonsuz düzgün-eksenel ortam arasında havadan dik gelen elektromagnetik alanlar için yansıma ve geçirme katsayılarını inceleyip, yansıma katsayısını nümerik uygulamalarda kullanılabilecek matris formda elde etmiştir.. Bu çalışmada ise, Şekil 1 de görüldüğü gibi x eksenine paralel spirallerin z=0 ve z=d yüzeyleri ile sınırlandırılmış kayıpsız bir yalıtkan ortama yerleştirilmesi ile elde edilen düzgün-eksenel bakışımsız levhaya dik gelen elektromagnetik dalganın levhadan yansıması ve geçmesi formüle edilip yansıma ve geçirgenlik katsayıları matris formunda elde edilmiştir.

PROBLEMİN FORMÜLASYONU

Problemi çözmek için Şekil 2 deki düzgün-eksenel bakışımsız levha içinde ikisi (+) z yönünde, ikisi (-) z yönünde ilerleyen toplam dört dalga olduğu varsayıldı. Levhaya dik gelen dalganın alan denklemleri

$$E'(z) = E'e^{-jk_0 z}$$
 $a_z \cdot E' = 0$ (8)
 $H'(z) = H'e^{-jk_0 z}$ fl...H'=0 (9)

$$H^{1} = \frac{1}{7} a_{z} x E'$$
 (10)

ve yansıyan dalganın alan denklemleri

$$E^{r}(r) = EV^{v}$$
 «_, $E^{r} = 0$ (11)

$$\mathbf{H}'(z) = \mathbf{H}' e^{\mu ror} \qquad \text{fl}_{\mathbf{H}} = 0 \qquad (12)$$

$$\mathsf{H}' = -\frac{1}{\eta_0} a_{,} \mathsf{x} \mathsf{E}' \tag{13}$$

şeklinde yazılabilir. Burda $k_n = iC \sqrt{y_1, g_0}$ ve

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \, \mathrm{dir.}$$

Bakışımsız ortama girince (+) z yönünde ikiye ayrılarak, sağa ve sola polarize olmuş, ilerleyen dalganın alan denklemleri

X DÜZGÜN-EKSENEL HAVA HAVA BAKIŞIMSIZ μeo μe, LEVHA (ē, ji, ic) - ---> Ε Ζ Z=d Z=0

ŞEKİL: 2 Sonsuz uzunlukta düzgün-eksenel bakışımsız levhaya dik gelen, yansıyan ve geçen elektromagnetik alanlar.

$$H;(.~) = H, e^{-R} \cdot + H f^{+*} a \cdot H, - 0$$
 (15)

$$\mathbf{H}_{\perp} = \frac{*}{Kn}, \quad (16)$$

olacaktır, burda

$$k_{t} = w\sqrt{\mu_{t}\varepsilon_{t}} \qquad \eta_{t} = \sqrt{\frac{\eta_{t}}{\varepsilon_{t}}} \qquad k_{t} = k_{t}\sqrt{A_{t}} \qquad (17)$$
$$A_{t} = \frac{1}{2}\left(\frac{\mu_{t}}{\mu_{t}} + \frac{\varepsilon_{t}}{\varepsilon_{t}}\right) = \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{\mu_{t}}{\mu_{t}} - \frac{\varepsilon_{t}}{\varepsilon_{t}}\right)^{2} + \frac{\kappa^{2}}{\mu_{t}\varepsilon_{t}}} \qquad (18)$$

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

100

formunda Kaynak [5] deki gibi tanımlanmıştır. $E_{_{1,2}}^{**}$ özdalgaları (eigenvvaves), e+ ve e. vektörleri cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir [4].

$$\mathbf{F}_{...}^{+} - \mathbf{F}_{...}^{-4} \mathbf{e}_{z} \qquad \mathbf{e}_{z} = s_{1,2} \mathbf{a}_{z} + j \mathbf{a}_{y}$$
(19)

$$s_{1,2} = \frac{k_t \sqrt{A_z}}{\kappa k_o} \left(A_{\pm} - \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_t}\right)$$
(20)

$$\mathbf{H}_{1,2}^{+} = \overline{Y}_{1} \mathbf{E}_{1,2}^{-}$$
 (21)

$$\vec{\tilde{Y}}_{\pm} = \frac{1}{\eta_t} (\sqrt{A_{\pm}} \boldsymbol{a}_x \boldsymbol{a}_y - \frac{1}{\sqrt{A_{\pm}}} \boldsymbol{a}_y \boldsymbol{a}_y)$$
(22)

Bu iki boyutlu tabanlar karşılıklı taban (reciprocal base) vektörleri *e*[ile çiftdikgenlik (biorthogonality) şartını aşağıdaki gibi sağlar.

$$e_{+}-el - e'_{-} = 1, e_{+} \cdot e'_{-} = e_{+} \cdot e'_{+} = 0$$
 (23)

Bakışımlı ortamda z=0 yüzeyine doğru ilerleyen diğer iki dalganın alan denklemleri

$$E_{t}^{-}(z) = E_{1}^{-} e^{i \mathbf{k}_{1}(z-d)} + E_{2}^{-} e^{i \mathbf{k}_{1}(z-d)} \qquad a_{z} \cdot \mathbf{C} ; = 0 \quad (24)$$

$$H_{t}^{-}(z) = H_{1}^{-} e^{i \mathbf{k}_{1}(z-d)} + H_{j} \mathbf{V}^{*} \mathbf{u}^{*} \mathbf{a}_{z} \cdot \mathbf{H}_{2}^{-} = 0 \quad (25)$$

$$H_{1,2}^{-} = -Y_{z} \mathbf{E}_{1,2}^{-} \qquad (26)$$

$$= = -Y_{z} \mathbf{E}_{1,2}^{-} \mathbf{E}_{2}^{-} = R_{2} \mathbf{E}_{2}^{+} e^{- \mathbf{k}_{2}} \mathbf{u}^{*}$$

şeklinde olacaktır. Levhadan z=d de havaya çıkan toplam dalga ise

$$\mathbf{E}'(z) = \mathbf{E}_{+}' e^{-jk_0(z-d)} \qquad \mathbf{a}_{+} = \mathbf{O}$$
 (28)

 $H'(z) = H_{+}'' e^{-jk_0(z-d)}$ $a_z - H_{+}' = O$ (29)

$$\mathbf{H}_{\star}^{t} = \frac{1}{\eta_0} \boldsymbol{a}_z \times \mathbf{E}_{\star}^{t}$$
(30)

şeklinde yazılır. Matris formundaki yansıma ve geçirme katsayılarının bulunabilmesi için z=0 ve z=d yüzeylerinde farklı ortamlardaki elektrik ve magnetik alanların teğet bileşenlerinin eşitliğinden hareketle aşağıdaki denklemler yazılır.

$$E'(0) + E'(0) = E/(0) + E_{c}''(0)$$
(31)
$$H'(0) + H'(0) = H^{*}(0) + H^{*}(0)$$
(32)

$$E_{c}^{+}(d) + E_{c}^{-}(d) = E^{t}(d)$$
(32)

$$H^{+}(a) + H^{-}(a) = H^{+}(a)$$
 (24)

$$H_{c}(d) + H_{c}(d) = H'(d)$$
 (34)

Gerekli düzenlemeler yapılır ve matris formundaki yansıma katsayısı R, E' = RE' şeklinde tanımlanarak Kaynak [4] deki yol izlenirse

$$\overline{R} = (\overline{I}, + \overline{v} \ y \cdot \overline{(i, -\overline{Y})})$$
(35)

formu elde edilir. Bunda

$$= a_{x}a_{x} + a_{y}a_{y} = e_{+}e_{+}' + e_{-}e_{-}' = a_{+}a_{+}' + a_{-}a'$$
(36)
=

$$Y = a_{+}e'_{+} + a_{-}e' = (e_{+}al + e_{-}a''\mathbf{y})$$
(37)

$$\boldsymbol{a}_{\pm} = \frac{\eta_o}{\eta_t} \left(\frac{s_{\pm}}{\sqrt{A_{\pm}}} \boldsymbol{a}_x + j \sqrt{A_{\pm}} \boldsymbol{a}_y \right)$$
(38)

dır. e_{\pm} vektörlerinde olduğu gibi a_{\pm} vektörleri de karşılıklı taban vektörleri ile çiftdikgenlik şartını

sağlamaktadır. (31) ve (32) den R_1 ve R_2 nin değerleri

$$\overline{R_{i}} = (\overline{Y}_{+} + \overline{I}_{t})^{-1} \cdot (\overline{Y}_{+}$$
(39)

$$\overline{R_2} = (7 + \overline{I_1})^{-1} \cdot (\overline{Y} - 7\mathbf{r})$$
(40)

şeklinde bulunur. BundaY \pm = $rj_{d}(a_{2} xY\pm)$ olup (33) ve (34) den

$$\overline{\overline{7}} - \overline{\overline{7}}_{+} e^{-j2k_{*}d}$$
(41)

elde edilir. Eğer bu değerier (31) de yerine konulursa ve E' = *T*- E' tanımından matris formundaki geçirme katsayısı

$$\overline{\overline{T}} = \left\{ \left[\overline{\overline{I}}_{t} + (\overline{Y}_{+} + \overline{I}_{t})^{-1} \cdot (\overline{\overline{Y}}_{+} - \overline{I}_{t}) \right] e^{-jk_{*}d} + \left[\overline{\overline{I}}_{t} + (\overline{\overline{Y}}_{-} + \overline{I}_{t})^{-1} \cdot (\overline{\overline{Y}}_{-} - \overline{I}_{t}) \right] e^{-jk_{*}d} \right\} (\overline{\overline{R}} + \overline{\overline{I}}_{t})$$
(42)

.....

elde edilir.

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ



SONUÇ

Bakışımsız paralel bir levhanın doğrusal bir dalgayı bir miktar döndürdüğü, polarizasyonunu deăistirdiăi bilinivor. Ceyrek dalga bovu kalınlıktaki böyle bir levhanın doğrusal bir dalgayı nasıl döndürdüğü ve iki tane çeyrek dalga boyu kalınlıkta paralel levha kullanılarak istenilen polarizasyondaki dalganın istenilen bir polarizasyondaki bir dalgaya başka çevrilebileceği Viitanen ve Lindell [5] tarafından açıklanmıştır. uygulamalarında Anten polarizasyon değistirici olarak kullanılabilen bu gecirme levhalarda dalganın yansıma ve katsayılarını bilmenin sağlıyacağı avantailar acıktır.

KAYNAKLAR

[1] D.L.Jaggard, A.R.Mickelson, and C.H.Papas "On electromagnetic waves in chiral media," Appl. Phys. Vol. 18, pp. 211-216, 1979.

[2] S. Bassiri, C. H. Papas, and N. Engheta, "Electromagnetic wave propagation through a dielectric-chiral interface and through a chiral slab," J. Opt. Soc. Am., vol. A5, pp.1450-1459,1988.

[3] M.H. Uman, V.V. Varadan and V.K. Varadan, "Rotation and dichroism associated with microvvave propagation in chiral composite samples," Radio Sci., vol.26, no. 5, pp.1327-1334,1991.

[4] I.V.Lindell and A.H.Sihvola, "Plane-Wave reflection from uniaxial chiral interface and its applications to polarization transformation," IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. 43, pp. 1397-1404, 1995.

[5] A.J. Viitanen and I.V. Lindell, "Uniaxial chiral quarter-wave polarisation transformer," Electron. Lett. Vol. 29, no. 12, pp. 1074-1075,1993.

SAVAŞ UÇKUN

ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümünden 1980 yılında mezun olan yazar 1983 yılında aynı bölümden bilgisayar donanımı üzerine ilk yüksek lisans derecesini, 1987 yılında State University of New York at Albany, Bilgisayar Bilimleri Bölümünden ikinci yüksek lisans derecesini ve 1992 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Doktora derecesini aldı. 1980 yılında mezun olduğu bölüme araştırma asistanı olarak giren, 1992 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak calışmaktadır, ilgi alanına elektromagnetik ve mikrodalga problemlerinin nümerik çözümlenmesi, saçılım, elektromagnetik menderes-biçimli polarizörler, bakışımsız(chiral) ortam ve uygulamaları ve gelişigüzel şekilli mikroşerit antenler girmektedir.

GÖLGE ÖĞÜCÜ

1973 yılında Gaziantep'te doğdu. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi'nden lisans derecesini aldı. Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Halen Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir, ilgi alanları Tamamen Benzesen Tabakalar (Perfectly Matched Lavers) ve Soğuran Ortamlar (Absorbing Mediums) dır.

DAİRESEL DİSK MİKROŞERİT ANTENLERDE HAVA AÇIKLIĞI KONTROLÜ İLE REZONANS FREKANSININ AYARLANMASI

Çiğdem S. GÜREL, Erdem YAZGAN

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 06532 - ANKARA

ABSTRACT:

The analysis of tunable circular disk microstrip antenna with air gap is performed in order to obtain its resonance frequency accurately. In the analysis, to determine the effect of air gap tuning on the resonance frequency, firstly, two-layered structure is reduced to the single layered one having eçuivalent effective permittivity and effective patch radius then Modified Wollf Model (MWM) is applied to that structure and dynamic permittivity expression is determined. The obtained resonance frequencies from this dynamic permittivity values agree very well with the available experimental results in literatüre for different modes and air gap thicknesses .

1. GİRİŞ

Mikroserit antenlerin dar bandgenişliği karakteristikleri uygulamalarda önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu antenlerde bandgenişliğini artırabilmek ve çalışma karakteristiklerini veni bir anten üretmeden değiştirebilmek üzere kullanılan tekniklerden birisi alt katman ile toprak düzlemi arasında bir hava açıklığı bırakılmasıdır [1], [2]. Yüksekliği ayarlanabilir bu açıklık ile hem efektif permittivitenin düşmesi hem de katman kalınlığının artmasından dolayı, rezonans frekansının ayarlanması ve bandgenişliğinin artırılabilmesi mümkün olmaktadır.

Mikroşerit antenlerin en verimli çalışma frekansı aralıklarının rezonans frekansı etrafında gerçekleşmesi ve bandgenişliklerinin de bu aralıkta artırılabilmesi nedenleriyle bu frekansın hassas hesabının yapılması oldukça önemlidir.

Dairesel parça mikroşerit antenler uygulamalardaki çeşitli üstünlükleri nedeniyle, sıkça literatürde yer almaktadır. Bu çalışmada, dairesel disk mikroşerit antenlerde rezonans frekansının hesabı ve hava açıklığının üzerindeki bu frekans etkilerinin belirlenmesi için Geliştirilmiş Wollf Modeli (MWM) kullanılmıştır. Bu model yapının dinamik permittivite değerinin belirlenmesine dayanır [3]. Bu amaçla yapının statik ve dinamik olmak üzere herbir değerinin belirlenmesi kapasitans aerekir. Bu çalışmada dinamik permittivite değerinin hesabı için yeni bir statik kenar kapasitansı ifadesi seçilmiş ve yapılan hesaplarda disk yarıçapı ve alt katman permittivitesi için fiziksel değerler yerine efektif değerler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, birçok durumda diğer teorik hesaplara göre daha az yüzdelik hata ile elde edilmis ve denevsel sonuclarla ivi bir uyum sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre rezonans frekansında oluşabilecek kaymaların hava açıklığı kontrolü ile önlenebileceği gösterilmiştir.



Hava açıklığı içeren dairesel disk mikroşerit anten Şekil 1' de verilmiştir:



Şekil 1: Hava açıklığı içeren dairesel parça mikroşerit anten geometrisi.

Bu yapının rezonans frekansı;

$$f_{r,nm} = \frac{\chi_{nm}}{2na_{eff} \sqrt{\mu \varepsilon_{dyn}}}$$
(1)

Eş.(1)'de X_{nm} , $J'_{n}(X_{nm}a_{eff}) = 0$ denkleminin bir çözümü, $a_{e}g$ efektif disk yarıçapı ve e_{dyn} parça kenarlarında oluşan alanların ve disk üzerindeki akım dağılımının etkilerini içeren dinamik permittivite değeridir. Efektif disk yarıçapı a_{gn} , $h_{\tau} = h_{1} + h_{2}$ olmak üzere $h_{T}/a \le 0.5$ ve $e_{S10} \le 10$ için verilen T r2 r2

$$e_{eff} = \mathbf{a} \left\{ 1 + \frac{2h_{T}}{7te_{r2}} \left[ln(\frac{\mathbf{a}}{2h})_{T} + (1.41c_{r2} + 1.77) \right] \right\}$$

$$\left. \begin{array}{c} h \\ + -\frac{x}{a} (0.268 e_{r2} + 1.65) \\ a \end{array} \right|^{1/2}$$
(2)

1 /0

Çift katmanlı yapının dinamik permittivite değerini elde etmek üzere ilk olarak üst katmanın efektif permittivite değeri bulunmuştur:

$$\varepsilon'_{r2} = \frac{1}{2}(\varepsilon_{r2} + 1) + \frac{1}{2}(\varepsilon_{r2} - 1)\left(1 + \frac{12h}{2}\right)$$
(3)

İki katlı yapıyı h_{τ} kalınlığında, eşdeğer permittivitesi e_{req} olan tek katlı bir yapıya dönüştürmek üzere boşluk modeli kullanılabilir [1]. Bu modelden elde edilen tek katmanlı yapının eşdeğer permittivite değeri:

$$\varepsilon_{\text{req}} = \frac{\frac{1}{2} \ln 22 \left(\frac{h_1}{2} + h_2 \right)}{\left(h_2 + r \cdot r_2 h_1 \right)}$$
(4)

Bu durumda eşdeğer tek katmanlı yapının kalınlık ve permittivite değerleri boşluk modelinden belirlenmiş olmaktadır. Ancak Eş.(4) 'deki ifadenin modal değişim etkilerini içermemesi nedeniyle, bu etkileri de içeren dinamik permittivite değerinin hesabı gerekir. Bu değer, tek katmanlı eşdeğer yapı için tanımlanabilir:

$$\varepsilon_{dyn} = \frac{C_{dyn} (\varepsilon_{ro > o'r2})}{C_{dyn} (°ro "e'r2 = 0)}$$
(5)

°dyn (°'r2'^Ero) = °o,dyn (°'r2'^ero) + °e,dyn (°'r2'^ero **) (6)**

Yapının dinamik kapasitans ifadesi C od yn [5]:

$$\mathbf{C}_{o,dyn} = \begin{cases} 0.3525C_{qstat} & ,n = 1\\ 0.2856C_{o,stat} & ,n = 2\\ 0.2450C_{qstat} & ,n = 3 \end{cases}$$
(7)

C_{ostat} eşdeğer yapının statik kapasitans ifadesidir:

$$\mathbf{C}_{\text{o, stat}} = \begin{cases} 2 \\ e & a & e & e \\ eff \text{ ro req} & I \\ 2 \\ e & a & c & r. \\ ro & req & I \\ ro & req & I \\ I \end{cases}$$
(8)

305

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

Dinamik kenar alan kapasitansı $C_{e,d yn}$ 'in belirlenmesi için ise elde edilmiş olan eşdeğer tek katmanlı yapı, bir dikdörtgen parça anten ile modellenmiş ancak fiziksel yarıçap değeri yerine daha önce tanımlanmış olan efektif disk yarıçapı kullanılmıştır. Buna göre dikdörtgen parça genişliği W=2a_{ett}- ve uzunluğu L=7ia_{ett}/2 olarak seçilmiş, elde edilen bu yeni yapının kapasitans değeri dairesel diske uyarlanmıştır [3]:

$$C_{e,dyn}(\varepsilon'_{req},\varepsilon_{ro}) = \frac{1}{4} \left(\frac{Z_{o}(2a_{eff},h_{T},\varepsilon'_{req}=\varepsilon_{ro}=1)L}{V_{o}Z(2a_{eff},h_{T},\varepsilon'_{req},\varepsilon_{ro})} - \frac{\varepsilon_{o}\varepsilon'_{req}\pi a_{eff}^{2}}{h_{T}} \right) (9)$$

Bu ifadenin ilk terimi, iletken parça üzerindeki Q yükünden dolayı oluşan toplam kapasitans C dir. Bu değer Variasyonel Method ile İletim Hattı Modelinden bulunabilir [6]:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{m_o'0} \int_{\beta h_T}^{\infty} \frac{[\tilde{f}(P)/Q]^2 i}{\beta h_T Y^{dp}}$$
(10)

Eş.(10)'da $\tilde{f}(P)$, yük dağılımı Q'nun Fourier dönüşümünü, Y ise, eşdeğer yapının iletim hattı modelinden elde edilmiş olan admittans fonksiyonunu göstermektedir:

$$Y = \frac{{}^{\circ}req}{tanh(ph_{\tau})} + 1$$
(11)

3. SONUÇLAR VE YORUMLAR

iki katmanlı yapının rezonans frekansı değerler farklı hava açıklıkları için Tablo 1'de sunulmuştur. Bu tabloda sunulan sonuçlar sırasıyla kaynak [1]' de sunulan deneysel ve teorik sonuçlarla, diğer kaynaklar [2], [7] ve [8]'de farklı metodlarla hesaplanmış olan teorik sonuçları içermektedir. Bu sonuçlar irdelendiğinde [1]'de verilen teorik sonuçların Tablo 1a' da hava açıklığı içerilmemiş olan durum için, deneysel sonuçlarla iyi bir uyum içinde olmasına rağmen hava açıklığı artırıldıkça güvenilirliğinin azaldığı görülmektedir. Eşdeğer permittivite ve disk yarıcapı icin secilen basit formüller üzerine geliştirilmiş olan bir diğer teori [2] ile elde edilen sonuçların da özellikle düşük dereceli modlar ve dar hava açıklığı değerleri için daha güvenilir oldukları görülmektedir. Kaynak [7]' de sunulan sonuçlar da permittivite değeri dinamik kullanılarak hesaplanmıştır. Ancak ilgili hesaplamalarda, bu calısmadakinden farklı bir statik kenar kapasitans ifadesi kullanılmış, diğer yapısal parametereler için de fiziksel değerler seçilmiştir. Bu sonuçlar, o zamana kadar elde edilenlerin en hassas olanları olmakla birlikte artan hava açıklığı ve yüksek dereceli modlarda hata oranı artmaktadır. Kaynak [8]' de geliştirilen ve eğri uyumlama yöntemine dayanan bir vaklasımla elde edilen sonucların ise diğerleri üzerine bir üstünlük sağlamadığı Tablo 1'den görülmektedir. hesaplanan sonuclar ise ortalama Bu calismada %0.47 gibi düşük yüzdelik hata oranı ile farklı hava açıklığı ve mod değerleri için diğer birçok durumdan daha hassas değerler olarak elde edilmiştir.

Sekil 2' de hava açıklığı içerilmeyen yapının rezonans frekansı ile normalize edilmiş rezonans frekansı değerlerinin, farklı hava açıklığı kalınlıkları ile değişimi gösterilmiştir. Bu kalınlık artırılarak, rezonans frekanslarının farklı değerlere kolayca ayarlanabileceği, özellikle alt katman permittivitesi artırıldıkça hava açıklığının rezonans frekansı üzerine olan etkisinin de artacağı görülmektedir. Buradan da bazı uygulamalarda anten üzerinde oluşabilecek ceşitli dış etkiler sonucu, rezonans frekansında ortaya çıkabilecek kaymaların ayarlanabilir hava açıklığı kullanılarak önlenebileceği sonucuna varılmaktadır.



ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

Tablo 1: Rezonans frekansı değerlerinin deneysel ve diğer teorik sonuçlarla kıyaslanması a-)h1=0, b-) h1=0.5mm, c-)h1=1mm, a=50mm, h2=1.59mm, e_{r2} =2.32. Frekans değerleri MHz cinsindendir.

Mod	<u>Deney</u>	[1]	[2]	[7]	[8]	Hesap
TM11	1128	1127	1130	1133	1123	1130
TM21	1879	1869	1877	1879	1869	1879
TM31	2596	2571	2582-	2585	2552	2571
			-a-	_		
Mod	<u>Denev</u>	[1]	[2]	[7]	[8]	<u>Hesap</u>
TM11	1286	1276	1277	1278	1270	1281
TM21	2136	2117	2118	2120	2112	2130
TM31	2951	2911	2914	2916	2883	2916
			-b-			
Mod	<u>Deney</u>	[1] .	[2]	[7]	[8]	<u>Hesap</u>
TM11	1350	1351	1348	1348	1342	1359
TM21	2256	2241	2235	2236	2231	2261
TM31	3106	3082	3075	3076	3047	3095





Şekil 2: Normalize edilmiş rezonans frekansı değerlerinin, hava açıklığı kalınlığı ile değişimi, a=25mm,h2=1.6mm.

acıklığı iceren dairesel disk mikroserit Hava antenlerde rezonans frekansı hesabı icin bu çalışmada seçilen yöntem, sağladığı çözümlerin farklı sayıda katman iceren yapılara aüvenilirliği, kolayca uyarlanabilir yapıda olması ve moment cözümündeki gibi metodu fazla işlem zamanı gerektirmeden hassalıkta cözümler avni sağlayabilmesi nedenleriyle bir cok avantajlar icermektedir.

TEŞEKKÜR:

Bu çalışma, TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından, Doktora Destek Programı altında desteklenmiştir.

KAYNAKLAR:

[1] Dahele, J. S., Lee, K. F., 1985, Theory and experiment on microstrip antennas with air gap. Proc. of the Institution of Electrical Eng. Pt H, 132, 455-460.

[2] Güney, K., 1994, Resonant frequency of electrically-thick circular microstrip antenna. Int. Journal of Electronics, 77, 377-385.

[3] Verma, A. K., Rostamy, Z., 1991, Modified Wollf Model for the determination of the resonant frequency of the dielectric covered circular microstrip patch antenna, Electronics Letters, 27, 2234-2236;

[4] Chew, W. C. , Kong, J. A., 1980, Effects of fringing field on the capacitance of circular microstrip disk. IEEE Trans. on Microw.Theory and Tech., 28, 98-104.

[5] Wollf, I., Knoppik, N., 1974, Rectangular and circular microstrip disk capacitors and resonators. IEEE Tran. on Micrw. Theory and Tech., 22, 857-864.

[6] Yamashita.E., 1968, Variational method for the analysis of the microstrip lines. IEEE Trans. on Microw. Theory and Tech., 16, 529-535.

[7] Abboud, F., Damiano, J. P., Papiemik, A., 1988, New determination of resonance frequency of circular disc microstrip antenna: application to thick substrate. Electronics Letters, 24, 1104-1106.

[8] Roy, J. S., Jecko, B., 1993, A formula for the resonance frequencies of circular microstrip patch antenna satisfying CAD requirements. Int. Journal of Microw. and Millim.Wave Comp. Aided Eng.3, 67-70.



DİFRAKSİYONUN GEOMETRİK TEORİSİ İLE REFLEKTÖR ANTEN ANALİZİ

CEM NAKİBOĞLU, ELİF URAY Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarhk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 06570 MALTEPE/ANKARA

ABSTRACT: In this study, the diffraction and reflection point on a surface which is arbitranly chosen m the form of z=f(x,y)has been found by using the Fermat's principle Then the reflected and transmitted etectric and magnetic fields at the reflection point, the diffraction point and the electnc and magnetic fields at an ohservation point are calculated along a ray Geometrical optics method is used to calculate this fields and the results are improved by applying geometrical theory of diffraction.

1. GIRİŞ

yüksek Optik metodlar frekanslı difraksiyonu dalganın yayılımı ve isitimlerinde sıklıkla kullanılır. lsın kavramı kullanılan ve sıklıkla ışın optiği oi?>;ah bilmen geometrik optik metodu da geien yansıyan ve kırılan alanlar için yayılımının belirlenmesinde dalva kullanılan yaklaşık bir yüksek frekans metodudur [1].

Geometrik optik metodu, aydınlık bölgede doğru sonuç verdiği halde kostik e süreksizlik bölgelerinde geometrik optik ue birlikte difraksiyonun geometrik teonsının (GTD) kullanılması gerekir [2,

2. GEOMETRIK OPTIK METODU

Fermat prensibi kullanılarak z=f(x,y) formunda verilen keyfi olarak seçilmiş bir i yüzeyi üzerindeki yansıma noktasını bulmak için

$$\frac{1}{d_1}\left\{ (x - x_s) + \left[f(x, y) - z_s \right] \frac{\partial f}{\partial x} \right\} + \frac{1}{d_2} \left\{ (x - x_0) + \left[f(x, y) - z_0 \right] \frac{\partial f}{\partial x} \right\} = 0$$
(1)

ve

$$\frac{1}{d_1}\left\{ (y - y_s) + \left[f(x, y) - z_s \right] \frac{\partial}{\partial y} \right\} + \frac{1}{d_2} \left\{ (y - y_0) + \left[f(x, y) - z_0 \right] \frac{\partial}{\partial y} \right\} = 0$$
⁽²⁾

nonlineer denklemleri elde edilmiştir [4]. Burada (x_s, y_s, z_s) kaynak noktasını $(x_0, yo>zo)$ gözlem noktasını gösterir. Yansıma noktasını bulmak için yüzey belirli bir sınır içinde alt bölgelere bölünmüş ve her bir alt bölgede yansıma noktası aranırken nümerik metodlar kullanılmıştır [5,6].

S yüzeyi dielektrik oli'ak alınmıştır. Yansıyan ışınlarm yanı sıra kırılan ışınlar da mevcuttur. Yansıyan ve kırılan elektrik alan

$$\vec{E}_{0}^{r,t}(P) \equiv E_{0}^{r,t}(\mathbf{2}) \sqrt{\frac{\mathbf{R}^{r,t}}{(s^{r,t} + \mathbf{R}_{1}^{r,t})(s^{r,t} + \mathbf{R}_{2}^{t,t})}} e^{-j\mathbf{k}s^{r,t}}$$
(3)

şeklindedir. $(\mathbf{R}_{i}^{\mathbf{r},\mathbf{r}})$. yarıcapları

 $(\mathbf{R}_{1}^{\mathbf{r},\mathbf{t}},\mathbf{R};^{4})$ eğrilik

$$\frac{1}{R_{1}^{r,t}}, \frac{1}{R_{2}^{r,t}} = \frac{1}{2} \left\{ Q_{11} + Q_{22}^{r,t} \right\}_{l} + \sqrt{\left(Q_{11}^{r,t} + Q_{22}^{r,t}\right)^{2} - 4\left(Q_{11}^{r,t}Q_{22}^{r,t} - Q_{12}^{r,t}Q_{21}^{r,t}\right)} \right\}$$
(4)

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

. .

= r tolarak verilir. BuradaÇ) eğrilik matrisleridir ve kırılan eş faz yüzeyin eğrilik matrisi,

$$\stackrel{=}{n_2} \left(\begin{array}{c} P \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} Q(z'=0)P \\ + \left(\frac{n_2}{n_1} \cos \theta' - \cos \theta' \right) \end{array} \right) \stackrel{=}{Q} \stackrel{=}{\sum}$$

(5) yansıyan eş faz yüzeyin eğrilik matrisi $\frac{z}{(2)} = \frac{z}{(2)} = \frac{z}{(2)} = \frac{z}{(2)} = \frac{z}{(2)}$

$$+2p \prod_{i=1}^{r} \left[\left(\frac{-i}{p} \right)^{i} \right]^{T} = \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{-i}{i} \right)^{i}$$
(6)

seklindedir.

3. DIFRAKSIYONUN GEOMETRİK TEORÍSI

Difraksiyonun geometrik teorisi problemi için bir E reflektörü gözönüne alınmıştır Koordinat sistemi başlangıcı ve yönlenimleri keyfi olarak seçilmiş kartezyen koordinatlarıdır. Reflektörün sınırlarını içeren kenar difraksiyon alanını hesaplamada dönüştürülmüş (primed) koordinat sistemi (x', y', z') yerleştirilmiş ve bunların kartezyen koordinatları ile tespit edilmiştir. Pratikte ilişkileri kullanılan reflektör sınırı T'nun iki tipi vardır. Bunlardan birisi silindir diğeri ise koni durumudur. Bu makalede her iki tip r sınırı da irdelenmiştir [7, 8].

Difraksiyon alanlarını hesaplamak için ilk olarak f sınırı üzerindeki O^d difraksiyon noktası difraksiyon kanunundan belirlenmistir. Kellerin yumuşak (soft) ve sert (hard) difraksiyon sabitleri ve dıverjans faktörü bulumuştur. Daha sonra herhangi bir O^d difraksiyon noktasını gözönünde bulundurduğumuzda P. gözlem noktasındaki difraksiyon alan dağılımı hesaplanmıştır. Eğer P_2 gözlem yansıyan gölge noktası sınırının yakımndaysa difraksiyon alanları yeniden hesaplanmıştır 19, 10]

4. SONUÇ

Bu makalede, I yüzeyi dielektrik alınmıştır. Yansıyan ışınların olarak yanı sıra kırılan ışınlara da geometrik optik ve difraksiyonun geometrik teorisi metodları uygulanarak herhangi bir ışın üzerinde bulunan gözlem noktasındaki alanlar bulunmuştur.

Bir ışın boyunca geometrik optik metodu kullanılarak hesaplanan yansıma noktasındaki yansıyan ve kırılan elektrik ve manyetik alanlar ile herhangi bir noktasındaki elektrik gözlem ve manyetik alan sonuçları difraksiyonun geometrik teorisi uygulanarak iyileştirilmiştir. Bu makalenin sonucunda bir program geliştirilmiştir ve yapılan bu program yüzey denklemi verilen bir antene uygulanmıştır [11] reflektör Yüzey denklemi

$$Z = r = f(x,y) = -15 \text{ f } 6.54 + \frac{y^2}{1} + \frac{y^2}{y^2} + \frac{y^2}{7}$$

şeklinde verilen bir reflektör antenin I sınır parametreleri

 $x_c = 0$ $y_c = 0$ 241?. a=5 p=5şeklinde olan bir silindir alınmıştır. P, kaynak noktası

.

 $x_s = 2/.$ $y_s = 4>.$ $z_s = -30>.$ noktasına ve P_s gözlem noktası Xo=2Â. $y_o = (10^2 sinQ)A$ $z_o = -(10^2 cosQ)>.$ yerleştirilmiştir noktasına Birinci ortamın kırılma indisi n,=0.8 ve ikinci ortamın kırılma indisi n; = 0.5 olarak seçilmiştir.

Frekans 300 Mhz alınarak O'nın değerleri için P₂ gözlem farklı noktasında geometrik optik alanlar ile difraksiyon alanları bulunmustur Bu farklı Q değerlerinden Q=30° icin programın sonuçlarını inceleyelim

noktası x=1 128? Yansıma y = 8.1452, z = f(x,y) = -2.8409koordinatlarında bulunmuştur Gelme açısı O'=8.8648°, yansıma açısı 0[°]=8.8648°, kırılma açısı o'= 14.2744" ve kritik açı ü°=38.6822° şeklinde elde edilmiştir. <)°>0' koşulu sağlanmıştır. Gelen ışının eğrilik yarıçapı R'=27 4874, vansıyan ısının eğrilik yarıçapı R'=4.1267 kırılan ışının eğrilik yarıçapı R^f = 21 0616 olarak bulunmuştur

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

QR yansıma noktasında hem yansıyan hem de kırılan alanlar mevcuttur. $Q_{\rm R}$ noktasında kırılan ve yansıyan elektrik alanların genliği

$$|\vec{E}_0'(Q_R)| = 3.7506 \text{ x } 10^{-2} \text{ x}^2 + 0.0237 \text{ x } 10^{-2} \text{ p}$$

+ 0.1007 x 10⁻² £

 $\left| \vec{E}_{0}'(Q_{R}) \right| = 0.6659 \text{ x } 10^{"'} \hat{\mathbf{x}} + 1.3749 \text{ x } 10^{"} \hat{\mathbf{y}}$

+ 7.4600x10[°] 'f şeklindedir. Bu durumda P₂ gözlem noktasında geometrik optik elektrik ve manyetik alanın genliği

 $\begin{vmatrix} \vec{E}_{0}(P_{2}) &| = 0.01042x + 0.57058\hat{y} + 0.2850\hat{I}\hat{Z} \\ |\vec{H}_{0}(P_{2}) &| = 0.1691 \text{ x } 10^{-2}\hat{x} + 0.4071 \text{ x } 10^{-3}\hat{j} \\ + 0.5367 \text{ x} 10^{-4} \text{\pounds} \end{vmatrix}$

olarak elde edilmiştir. $n=30^{\circ}$ için difraksiyon noktası mevcut olup O^d difraksiyon noktasının koordinatları x'=0.6319, y'=5.2009, z'=5.0000 şeklinde olmuştur.

Şekil 1'de Q'nın değişimine göre P₂ gözlem noktasındaki geometrik optik elektrik alanlar görülmektedir.



ŞEKİL 1: Geometrik optik elektrik alan

Şekil 2'de ise fi'nın değişimine göre P_2 gözlem noktasındaki geometrik optik ve toplam elektrik alanlar birlikte görülmektedir. Elektrik alanlar da Şekil 2'den de görüldüğü gibi hızlı bir osilasyon sözkonusudur. Bu E_0 geometrik optik alanı ve E^d difraksiyon alanı arasındaki farklı faz ilişkisinden dolayıdır.



ŞEKİL 2: Toplam elektrik alan.

Kostik noktası civarında diverjans faktörü sonsuz büyüklükte olmaktadır. Bu yüzden yazılan program kostik noktası civarında alan hesaplanmasında kullanılamaz. Kostik noktası ile karşılaşıldığında program başa dönerek yeni bir gözlem noktası istemektedir.

KAYNAKLAR

[1] Balanis, C.A., 1989, Advanced Engineering Electromagnetics, VViley.

[2] Keller, J.B., 1957, "Diffraction by an aperture", J. Appl. Physics, vol.28, pp.426-444, April.

[3] Lee, S.W., 1975, "Electromagnetics reflection from a conducting surfaces geometrical optics solution', IEEE Trans. Antennas Propagat., vol.AP-23, no.2, pp. 184-191, March.

[4] Uray, E. ve Nakiboğlu, C, 1995, "Geometrik optik metoduyla alanlar hesabı*, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa 11-17 Eylül, cilt 2, sayfa 680-683.

[5] Chapra, S.C. and Canale, R.P., 1988, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill.

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

[6] Cherin, A.H., 1985, An Introduction to optical fibers, McGravv- Hill.

[7] Kouyoumjian, R.G. and Pathak, P.H., 1974, "A uniform geometrical theory of difraction for an edge in a perfectly conducting surface", Proc. IEEE, vol.62, pp. 1448-1461, November.

[8] Keller, J.B., 1962, "Geometrical theory of diffraction", J. Opt. Soc. of America, vol.52, no.2, pp.116-130, February.

[9] Lee, S.W., 1977, "Uniform asymptotic theory of electromagnetic edge diffraction: A review", Univ. Illinois at Urbana-champaign, EM Lab Rep. 77-1, January.

[10] Lee, S.W., 1979, "Diffraction by an arbitrary subreflector: GTD solution",IEEE Trans. Antennas Propagat., vol.AP-27,no.3, pp. 305-316, May.

[11] Uray, E. , 1996, "Difraksiyonun Geometrik Teorisi ile Reflektör Anten Analizi", Y.Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Elektrik- Elektronik Müh. Böl., Ankara.

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

. .



DÜZGÜN OLMAYAN ÖRNEKLEME TEKNİKLERİNİN DEMET YAYILIM METODUNA (BPM) UYGULANMASI

CEM NAKİBOĞLU, ELİF URAY Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 06570 MALTEPE/ANKARA

ABSTRACT. The BPM (Beam Propagation Method) Is a widely used technique to investigate the field propagation in integrated optics. This method $p \in < > " < \cdots " %$ a spectral propagation algorithm to propagate an arbitrary incident beam through a meüioro of slowly varying refractive index. The BPM combmeö : $- < h^h$ he real ray tracing technkjues can be used to tackie EM reflection and refraction problems at curved interfaces. The problem becomes more compilicated when one traces the transmitted ray in f.\ ?;:rond medium. This paper represent twodime • Monal sampling technique which can utilize non-uniformiy spaced data points in the second region whose refractive index is n_2 .

RIS

Demet yayılım metodu (BPM) rastgele seçilen bir demetin (beam) kırılma indisi yavaş değişen bir ortamda yayılımmı incelemek üzere geliştirilmiş olan spektral bir yayılım metodudur. Buna rağmen BPM skaler TE-Fock denkleminin çözümünü vermekte ve yansıyan alanlar ihmal edilmektedir. Ayrıca bu metot izotropik olmayan dalga klavuzlarında TE/TM polarizasyon değişimlerini incelemek üzere de kullanılmaktadır IH

Bu bildiride BPM nin temel sınırlamalarını ortadan kaldırmak üzere değişik bir yaklaşım önerilmistir. Bu amaçla kapsamlı bir yazılım (software) geliştirilmiştir, iki boyutlu uzayda, örneğin xz- düzleminde, satır ve sütun aralıkları birbirine eşit olan bir ağ tanımlanmıştır. Giriş işareti olarak alınan Gauss demeti FFT (Fast Fourier Transform) teknikleri kullanılarak düzlemsel dalga spektrumuna ayrıştırılmış ve bu spektrumu olusturan her bir düzlemsel dalganın verilen ortamdaki yayılımı göz önüne alınmıştır. Propagasyon doğrultusu olarak kabul edilen z-ekseni doğrultusunda belirti sayıda kesitler tanımlanmış TE-TM FFT ve alanları yeniden kullanılarak bu kesitler üzerinde oluşturulmuştur. Öte yandan gözlem noktaları ikinci ortamda düzgün olarak dağılmadığından kırılan alanlar FFT teknikleri ile bulunamazlar. Bu nedenle kırılan alanları yeniden oluşturmak üzere düzgün olmayan örnekleme teknikleri kullanılmıştır [2], [3].

2. DÜZGÜN OLMAYAN ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ

Bu bildiride geliştirilen yazılımda kullanılan iki düzgün olmayan örnekleme tekniği ayrıntılı bir biçimde verilecektir.

A. Algoritmal:

t=x, (1=1,2,3....N) örnekleme noktalarının keyfi bir biçimde dağıldığını kabul edelim B cps den daha büyük frekans bileşeni mevcut olmayan bir f(t) işaretinin bu örneklerden yeniden elde edilmesi (Demodülasyon).

$$\mathbf{f}(\mathbf{t}) = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{f}(\tau_i) \Psi_i(\mathbf{t})$$
(1)

şeklindedir. Burada Ψ_{ι} (t) interpolasyon fonksiyonudur ve

$$\Psi_{r}(t) = \sum_{k=1}^{N} a_{ik} \frac{\sin\left[\left(\frac{K}{T}\right)(t-\tau_{k})\right]}{\left(\frac{n}{T}\right)(t-\tau_{k})}$$
(2)

bağıtısı ile verilir. $a_{\rm lk}$ lar bilinmeyen katsayılardır ve belirsiz Lagrange çarpanları olarak adlandırılır [4]. f(t) işaretini örnekleme noktalarında yeniden elde etmek için 4^{*}ı (t)intrpolasyon fonksiyonu, \ kronecker delta olmak üzere,

$$\Psi_{i}(t) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & , i = j \\ 0 & , i \neq j \end{cases}$$
(3)

koşulunu sağlamalıdır. (2) eşitliğinde t=x, konulursa,

$$\Psi_{t}(\mathbf{t}) = \sum_{\mathbf{k}=1}^{N} \mathbf{a}_{\mathbf{i}\mathbf{k}} \mathbf{c}_{\mathbf{i}\mathbf{j}}$$
(4)

elde edilir, öyleki

$$b_{\mathbf{k}j} = \frac{\frac{1}{\sin\left[\left(\frac{\pi}{\mathbf{T}}\right)\left(\tau_{\mathbf{k}} - \tau_{j}\right)\right]}}{\left(\frac{\pi}{\mathbf{T}}\right)\left(\tau_{\mathbf{k}} - \tau_{j}\right)}$$
(5)

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

(312

bağıntısı ile verilir. Öteyandan (3) koşulunun sağlanması gerektiğinden

$$\Psi_{i}(\tau_{j}) = \sum_{k=1}^{N} a_{ik} c_{kj} = \delta_{ij}$$
(6)

yazılabilir. Eğer (6) eşitliği matrisyel formda ifade edilirse, I birim matris olmak üzere,

ve dolayısıyla,

$$iAJ = ter^{1}$$
 (8)

olur. LA] ve IC1 matrisleri sırasıyla $a_{,k}$ ve c^* , katsayılarını içeririer, $a_{,k}$ katsayıları beliriendikten sonra f(t) fonksiyonları (1) ve (2) eşitlikleri kuüapnsrsk yeniden elde edilebilir.

B Algontrrv.2:

Burada bazı örnekleme noktalarının yok olması durum.:; göz önüne alınacaktır. ft(I+2)T] değerinm mevc.!¹ olmadığını, fakat bunun yerine f(t,*₂) değerinin b.; tdtğini kabul edelim. Öyleki t,*₂ /T oranı bir tam sayı değildir. Yok olan V örnek yerine f(t_p), (p=1,2,3....N) örnekleri konulmuştur (t_p/T bir tam sayı değildir) Bu durumda yeniden elde edilen f(t) fonksiyonu;

$$f(t) = \sum_{u=1}^{n} f(nT) \frac{\sin\left[\binom{\pi}{T}(t-nT)\right]}{\binom{\pi}{T}(t-nT)} + \cdot 2 >_{p}T) \frac{\sin\left[\binom{\pi}{T}(t-n_{p}T)\right]}{\binom{\pi}{T}(t-n_{p}T)}$$
(9)

bağıntısı ile verilir. Sağ taraftaki birinci toplam f(nT) bilinen değerlerini ve ikinci toplam ise f(n_pT) bilnmeyen değerlerini içerir. O halde V bilinmeyenli V denklemden oluşan bir doğrusal denklem sistemi yazılabilir. f(n_pT) değerleri beliriendikten sonra f(t) fonksiyonu ayrık (dicrete) Fourier dönüşüm tekniklen ile yeniden elde edilir.

3. NÜMERİK SİMÜLASYON

Şekil 1 ile verilen giriş işaretinin (Gauss için) Fourier dönüşümü şekil 2' de verilmiştir. Şekil 3a-3c ise bir Gauss demetinin keyfi olarak seçilen bir aıakesıtın varlığı altında yayılımını (propagation)

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

göstermektedir. Burada düzgün olmayan örnekleme teknikleri kullanılmıştır.

4. KAYNAKLAR

[1] Feit, Fleck, "Beam propagation in uniaxal anisotropic media, JOSA, vol.73, No.7, pp.920-924, 1983.

[2] Yen J.L., "On nonuniform sampling of bandwithlimited signals, IEEE Trans. Circuit Theory, vol.CT-3, pp.251-257,1956

[3]Yayrta Ramat-Samii. Cheung, RL "Non-uniform Sampling Techniques for Antenna Applications", IEEE Trans. Antennas Propagat , vol.AP-35, pp268-279, 1987.

[4]Courant R., Helbert D., "Methods of Mathematical Physics", vol.2, Wiley, 1989.



ŞEKİL 1: Giriş Gauss işareti (örnek sayısı=64, sigma=1.0)

(313)



ŞEKİL 2: Giriş işaretinin Fourier dönüşümü.



ŞEKİL 3a: Gelen dalga (incident field). Keyfi seçilen noktalar maksimum değeri z=69.8 (mikron) olan bir parabol üzerinde yer almaktadır. n₁=2.2, 02=2.65 ve Gauss işaretinin genliği 1.0 dır.



ŞEKİL 3b: Yansıyan alan



ŞEKİL 3c: Kınlan (transmitted) alan (z=80 mikron). İşaret düzgün olmayan örnekleme teknikleri ile elde edilmiştir.

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

(314

DAİRESEL OLARAK BÜKÜLMÜŞ pPTİK FİBERLERDE IŞIMA MODLARININ ETKİLEŞMESİNİN KOSTİK ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ

Cahit CANBAY, N.Özlem ÜNVERDİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 80670, Maslak - İSTANBUL Tel :(212) 2761042 Fax :(212) 2761300

Abstract - In this study, the mutual coupling mechanism for circular bent bare slab optical fibers which are on the same plane is investigated. The radiation in bent optical fibers is tangent to the caustic. For this case, the effective lengths'of two bent optical fibers in mutual coupling are analytically examined. In addition, the effective lengths are also investigated by assuming that the radiation is in radial direction. The effects of the mutual coupling on the modes of optical fibers are determined.

I. GİRİŞ

Dielektrik dalga kılavuzları arasındaki karşılıklı etkileşme mekanizması, kayıp analizinde önemli bir yere sahiptir. Kırılma indisi dağılımındaki değişimler, çekirdek bölgesi ile kılıf bölgesi arayüzeyindeki düzgün olmayan sınır özellikleri, bükülme ve mikrobükülme gibi optik dalga kılavuzlarının geometrilerindeki bozukluklar ve ortam parametrelerindeki düzensizlikler nedeniyle optik dalga kılavuzlarının modları arasında kuplaj söz konusu olur [1] - [5].

Birbirine yakın konumdaki optik dalga kılavuzlarında, kılavuzların alanlarından bir kısmı, diğer kılavuza küple olur. Maksimum kuplaj, aynı propagasyon sabitine sahip modlar arasında gerçekleşir [6]. Optik dalga kılavuzlarının karşılıklı etkileşme analizinde, kılavuzların özdeş olmaları ön koşulu yoktur.



Şekil.1 Dairesel olarak bükülmüş kılıfsız katmanlı iki optik fiber.

Bu çalışmada, Şekil.1'de görülen aynı düzlemdeki dairesel olarak bükülmüş kılıfsız katmanlı zayıfça kılavuzlayan kayıpsız iki optik dalga kılavuzunun karşılıklı etkileşme mekanizması. Küple Mod Teorisi ve Semer Noktası Metodu yardımıyla incelenmiştir.

II. DAİRESEL OLARAK BÜKÜLMÜŞ KILIFSIZ KATMANLI OPTİK FİBERLERDE KARŞILIKLI ETKİLEŞİM ANALİZİ

Şekil.2'de yer alan dairesel olarak bükülmüş konumdaki kılıfsız optik fiberde ışıma, radyasyon kostiğine teğet doğrultudadır [7,8], Bu nedenle, optik fiberler arasındaki karşılıklı kuplaj, sadece optik fiberlerin aynı düzlemde olmaları durumunda incelenebilir.



Şekil.2 Katmanlı iki optik fiber.

Bu durumda, Şekil.2'ye göre, çember denklemleri [9],

$$(x_{o1} - A_{1})^{2} + (y_{o1} - B_{1})^{2} = R_{1}^{2}$$
 da).

$$(x_{02} - A_2)^2 (y_{02} - B_2)^2 = R_2^2$$
 (1b)

ve teğet denklemleri,

$$(x - x_{01})(x_{01} - A_{01}) + (y - y_{01})(y_{01} - B0 = 0$$
 (2a)

$$(x-x_{02})(x_{02}-A_{2}) + (y-y_{02})(y_{02}-B_{2}) = 0$$
 (2b)

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI



olarak yazılır. Burada, (A^{BO} ve (A₂,B₂) bükülmüş optik fiberlerin merkezlerinin koordinatları, R, ve R₂ optik fiberlerin radyasyon kostiği yarıçapları, (x₀ı,yoı) ve (x₀;,y₀:) dairesel olarak bükülmüş katmanlı optik fiberlerin teğet noktalarıdır. Eğer AL A₂, B₁, B₂, Rı ve R₁ biliniyorsa. (x₁₁,y₀₁) ve (x₀2,yo₂) bulunabilir.



Şekil.3 Değişik propagasyon doğrultularına göre etkin uzunluklar.

-

(1a) ve (1b) eşitliklerinden,

$$y_0 I = + [R_1^2 - (x_0 I - A_1 r J)]^{1/2} + B_1^2$$
 (3)

$$y_{02} = \overline{f} \left[R_2^2 - (x_{02} - A_2)^2 \right]^{\nu_2} + B_2^2$$
 (4)

ve (2a), (2b), (3) ve (4) eşitliklerinden,

$$x_{02} = \exists (R_2/R_1)(x_{01} - A_2) + A_2$$
 (5)

olarak elde edilir.

Bu durumda, x_0 ı'in belirlenmesi için, y_{01} , y_{02} ve x_{02} 'nin işaretlerine bakılmalıdır. Eğer y_{01} ve y_{02} aynı işaretli ve x_{02} pozitif işaretli ise, ışıma, optik fiberler arasında ortak dış teğet, ve eğer y_{01} ve y_{02} farklı işaretli ve x_{02} negatif işaretli ise, ışıma, optik fiberler arasında ortak iç teğet olarak değerlendirilir.

Şekil.3 göz önüne alınarak, Bı - $B_2 \ge 0$ için, birinci optik fiberin ikinci optik fiber tarafından etkilenen bölgesi,

$$S_{r} = 2R_{1} \arcsin \left\{ \frac{1}{\sqrt{2d}} \left[d^{2} - (R_{1}^{2} - R_{2}^{2}) + \dot{a}_{o} I_{+} \right]^{1/2} \right\}$$
(6)

ve birinci optik fiberin ikinci optik fiberi etkilediği bölgesi ise,

$$s_{2} = 2R_{1} \arcsin\left\{\frac{1}{\sqrt{2d}}\left[d^{2} - (R_{1}^{2} - R_{2}^{2}) - t_{d}^{2}, d^{2}\right]^{1/2}\right\}$$
 (7)

olarak bulunur. Burada, R_I ve R_2 optik fiberlerin radyasyon kostikleri yarıçapları, d optik fiberlerin merkezleri arasındaki uzaklık. I, ve I_d ortak iç teğet ve ortak dış teğet uzunluklarıdır. Örneğin, Şekil.3(a)'da $I_d = KP$, 11 = LT = SM'dir. Birinci optik fiberi referans alarak yapılan bu analiz, ikinci optik fiberi referans alarak yapılacak olan çalışma için de geçerlidir.

Görüldüğü gibi, optik fiberlerden birisinin diğer optik fiber tarafından etkilenen bölgesi, radyasyon kostiğinde ortak iç teğet ve ortak dış teğet noktaları arasındaki uzun yay uzunluğuna, bu optik fiberin diğer optik fiberi etkilediği bölgesi ise radyasyon kostiğinde ortak ic teğet ve ortak dıs teğet noktaları arasındaki kısa yay uzunluğuna eşittir ve propagasyon doğrultularına göre herhangi bir değişim göstermemektedir. Şekil 4(a)'da birinci optik fiberin ikinci optik fiber tarafından etkilenen bölgesinin birinci optik fiberin kostiği radyasyon yarıçapına göre değisimi, Şekil.4(b)'de birinci optik fiberin ikinci optik fiberi etkilediği bölgesinin birinci optik fiberin radyasyon kostiği yarıçapına göre değişimi görülmektedir.

ELEKTRİ



Şekil.4a)Birinci optik fiberin ikinci optik fiber tarafından etkilenen bölgesinin birinci optik fiberin radyasyon kostiği yarıçapına göre değişimi.

b)Birinci optik fiberin ikinci optik fiberi etkilediği bölgesinin birinci optik fiberin radyasyon kostiği yarıçapına göre değişimi.

III. RADYAL IŞIMA YAKLAŞIMI

II.Bölüm'de açıklandığı gibi, dairesel olarak bükülmüş kılıfsız optik fiberde ışıma, radyasyon kostiğine teğet doğrultudadır. Bu bölüm'de, literatür'deki [31 halka anten yaklaşımı dikkate alınmış ve dairesel olarak bükülmüş kılıfsız optik fiberde ışıma-



Şekil.5 Dairesel olarak bükülmüş kılıfsız katmanlı optik fiberlerde radyal ışıma.

nın, Şekil.5'deki gibi radyal doğrultuda olduğu kabul edilerek karşılıklı kuplaj mekanizması araştırılmıştır.

Şekil.5'e göre, birinci optik fiberin radyal ışımasının ikinci optik fibere teğet olduğu noktaların koordinatları,

$$A_{m,n} = \frac{R_2^2(A_1 - A_2) \mp R_2 |B_1 - B_2| (U^2 - R_2^2)^{1/2}}{d^2} + A_2 \quad (8)$$

5

ì

$$f_{m,n} = \mp \frac{R_2}{d^2} \int d^4 - i \left[R_2 (A_1 - A_2) + T B_1 - B_2 | \left[d^2 - R \right] \right]^2 \int d^4 + B_2$$
(9)

dir. Burada, (A^ABO ve (A_2, B_2) bükülmüş optik fiberlerin merkezlerinin koordinatları, R_1 ve R_2 optik fiberlerin radyasyon kostiği yarıçapları, d optik fiberlerin merkezleri arasındaki uzaklıktır. (8) ve (9) eşitliklerinin değerlendirilmelerine göre dört durum söz konusu olur. Ancak, bu dört durum için de, ikinci optik fiberin birinci optik fiber tarafından etkilenen bölgesi,

$$p = 2 R_2 \arcsin\left[\frac{(d^2 - R_2)^{\nu^2}}{d}\right]$$
(10)

olarak elde edilir. Benzer mantıkla, radyal ışıma koşulunda, birinci optik fiberin ikinci optik fiber tarafından etkilenen bölgesi,

$$\tilde{\mathbf{p}} = 2 R_1 \arcsin \left[\frac{(d^2 - R_1^2)^{1/2}}{d} \right]$$
 (11)

şeklinde yazılır. Görüldüğü gibi, bu yaklaşım altında, bükülmüş optik fiberlerin karşılıklı etkileşmelerinde etkin olan uzunluklar, etki altındaki optik fiberin radyasyon kostiği yarıçapı ve optik fiberlerin merkez-



Şekil.6 Radyal ışıma yaklaşımında, ikinci optik fiberin birinci optik fiber tarafından etkilenen bölgesinin ikinci optik fiberin radyasyon kostiği yarıçapına göre değişimi.

leri arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişim göstermektedir.

Şekil.6'da, etkilenen optik fiberin, ikinci optik fiber olması koşulunda, etkilenen bölgenin ikinci optik fiberin radyasyon kostiği yarıçapına göre değişimi yer almaktadır.

V. OPTİK FİBERLERİN KARŞILIKLI ETKİLEŞMELERİNİN MODLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Şekil.1'deki kılıfsız bükülmüş optik fiberlerde modal propagasyon sabitinin değişimi, Küple Mod Teorisi ışığında,

$$\Delta \beta = \mp \frac{\omega \varepsilon_0}{4 P} \left(n_1^2 - n_2^2 \right) \iint_{\phi} \vec{E}_2 \cdot \vec{E}_1 r \, dr \, d\phi \qquad (12)$$

olarak ifade edilir [9]. Burada, nı ve n₂ sırasıyla optik fiberin ve optik fiberin dış ortamının kırılma indisi, \tilde{E}_1 birinci optik fiberin alanı, \vec{E}_2^{\bullet} ikinci optik fiberin alanının kompleks eşleniğidir. Zamana göre değişim exp(jrot) olmak üzere, dairesel olarak bükülmüş kılıfsız optik fiberin dısındaki alan ifadesi,

$$E_v = D H \leqslant r'(n_i, k_o r') e^{i v \phi}$$
(13)

olarak yazılır. Burada, D modlara göre belirlenen katsayı, n₂ dış ortamın kırılma indisi, ko=ro((ioe.o)^{1/2} boşluktaki dalga sayısı, v <>>hin separasyon sabitidir. Bu çalışmada, (13) eşitliği, Hankel fonksiyonunun asimptotik ifadesi [10] ve Semer Noktası Metodu'ndan yararlanılarak, bükülmüş optik fiberlerin karşılıklı etkileşmelerinin propagasyon sabiti üzerindeki etkisi modlara göre irdelenmiştir. Işıma modlarının bir kısmını temsil eden ve kompleks propagasyon sabitine sahip olan sızıntılı modlar arasındaki kuplajın. kılavuzlanmış modların evanescent alanları arasındaki kuplajdan daha etkili olduğu ve ayrıca TE çift modları arasındaki kuplajın, diğer modlar arasındaki kuplajdan daha büyük olduğu görülmüştür.

V. SONUÇ

Bu çalışmada, aynı düzlemde bulunan dairesel olarak bükülmüş kılıfsız katmanlı kayıpsız iki optik fiberin karşılıklı etkileşme mekanizması analitik olarak incelenmiştir. Etkin uzunlukların bağlı oldukları parametreler açıklanarak, bu uzunlukların radyasyon kostiği yarıçapına göre değişimleri irdelenmiştir. Radyal ışıma koşulu için yapılan kuplaj analizinden sonra optik fiberlerin karşılıklı etkileşmelerinin modlar üzerindeki etkileri Küple Mod Teorisi ve Semer *Noktası Metodu* \\e değerlendirilmiştir. [1] D.Marcuse, *Theory of Dielectric Optical Waveguides*, Academic Press, New York, 1974.

[2] D.Marcuse, *Light Transmission Optics,* Second Ed., Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1982.

[3] A.W.Snyder, J.D.Love, *Optical Waveguide Theory*, J.W.Arrowsmith Ltd., Bristol-Great Britain, 1983.

[4] C.Canbay, N.Ö.Ünverdi, S.Polat, "Düz ve Bükülmüş Fiber Optik Hatlarda Modal Etkileşim Analizi", Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, 13-18 Eylül 1993, KTÜ-Trabzon, Cilt:2, Sayfa:392-397.

[5] C.Canbay, N.Ö.Ünverdi, "Düz ve Bükülmüş Optik Fiberlerde Etkileşim Analizi", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, 11-17 Eylül 1995, Uludağ Üniversitesi-Bursa, Cilt:2, Sayfa:794-797.

[6] W.H.Loisell, *Coupled Mode and Paramethc Electronics*, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1960.

[7] A.V.Snyder, J.D.Love, "Reflection at a Curved Dielectric Interface - EM.Tunneling", IEEE Trans. Microwave Theory Tech., Vol. MTT-23, No.1, pp.134-141, Jan.1975.

[8] J.D.Love, A.W.Snyder, "Generalized Fresnel's Laws for a Curved Absorbing Interface", J.Opt.Soc. Amer., Vol.65, No.9, pp.1072-1074, Sept. 1975.

[9] N.Ö.Ünverdi, C.Canbay, "Mutual Coupling Analysis Beetween Bent Optical Fibere", Melecon'96, 8th Mediterranean Electrotechnical Conference, May 13-16, 1996, Bari, Italy, Vol.II, pp.697-700.

[10] M.Abramovitz, I.A.Stegun, "Handbook of Mathematical Functions", Dover Pub.Inc, New York, USA, 1972.

CAHİT CANBAY 1951 de Sivas'ta doğdu. 1974'de İstanbul Üniversitesi'ni tamamladı. 1986'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde doktorasını verdi. Halen aynı bölümde Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dah'nda Y.Doç.Dr. olarak çalışmaktadır.

N.ÖZLEM ÜNVERDİ 1967'de Aydında doğdu. 1989'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 1991'de aynı bölümden yüksek lisans derecesi aldı. Halen Y.T.Ü.'nde doktora programına kayıtlı olup, aynı zamanda, Y.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dah'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bu çalışma, 91-B-04-03-03 no.lu proje kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu ve EEEAG/AY-18 no.lu proje kapsamında TÜBİTAK Araştırma Altyapısını Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir.

_ _ . . _ ___

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

(318)

Özgün Düşük Gürültülü Aktif Anten Dizisi Analiz ve Tasarım Yöntemi

S.DEMIR, C. TOKER, A. HIZAL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 06531 ANKARA

ABSTRACT

In this work, noise analysis of active receive antenna systems are given. Noise analysis of low loss transmission lines is given and a new concept, 'noise eçuivalent line length' is introduced. Importance of incoherent impedance match is shown and based on the noise equivalent line length, noise performance of different antenna array feed structures are also studied. It is shown that an antenna array feed structure can be re-designed without affecting the radiation performance for a lower noise temperature. It is also shown that active antenna arrays may have superior noise performance compared to passive antenna arrays. Application of noise equivalent line length as an active circuit replacement chteria in antenna arrays is given.

1. GİRİŞ

Gürültü, alıcı anten sistemleri için önemli bir tasarım kriteridir. 1960'lardan beri alıcı anten sistemlerinde gürültü faktörlerinin belirlenmesi, hesaplanması konularında çalışmalar yapılmaktadır [1]. Son yıllarda aktif anten yapıları kullanılmaya başlanmıştır. Aktif anten yapıları için de gürültü analizi ve ölçümleri konularında çalışmalar sürmektedir [2]. Ancak, bu çalışmaların hiçbirinde anten besleme yapısının kendi gürültü sıcaklığı hesaba katılmamış, tasarımlarda bu sıcaklığı azaltma konusu dikkate alınmamıştır. Alıcı antenlerde gürültü sıcaklığının ölçülmesi çok zor olduğu için güvenilir bir analiz yöntemi son derece önemlidir. Besleme yapılarında kullanılan iletim hatlarının kayıplı olması gürültü faktörünün hesaba katılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle büyük ölçekli anten dizilerinde besleme yapılarında oluşan kayıplar anten verimliliğini %70'ler seviyesine indirmektedir [3]. Aynı nedenle, kayıp faktörü ile doğrudan ilişkili olan gürültü faktörü de önemli derecede artmaktadır.

Anten dizilerinin gürültü sıcaklığının belirlenmesi ve düşük gürültülü bir besleme yapısının tasarımı ve analizi çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmada, aktif anten dizisi tasarımına uygulanması sunulmaktadır. Anten besleme yapıları seri ve paralel tipte olmak üzere iki ayrı grupta incelenebilir. Bu çalışmada daha yaygın kullanıma sahip olan paralel besleme yapıları esas alınmıştır.

Paralel besleme yapıları temel olarak güç birleştirici yapılardır. Işınım örüntüsüne bağlı olarak antenlerden faz ilintili (coherent) gelen işaretler, besleme yapısı üzerinde birleştirilerek anten çıkışına aktarılırlar. Anten dizisi, dişarıdan alınan işaret ve gürültü için aynı biçimde davrandığından, bu biçimdeki çalışma, işaret-gürültü oranı (SNR) analizi çalışmalarına temel oluşturmuştur [4]. Ancak, kayıplı elemanlardan oluşan besleme yapısı kendi başına ısıl (thermal) gürültü oluşturduğu için, hem dışardan alınan gürültü ile hem yapı içindeki diğer elemanların yarattığı gürültü ile faz ilintili değildir (incoherent). Bu nedenle şimdiye kadar yapılan çalışmalardan tamamen farklı bir çalışmayı gerektirmektedir.

2.KAYIPLI İLETİM HATTI GÜRÜLTÜ HESABI

Anten dizisi besleme yapıları bir çok uygulamada iletim hatları ile oluşturulur. Bu nedenle, kayıplı iletim hatlarının gürültü analizi, besleme yapılarının gürültü analizinde oluşturmaktadır. temel Yaptığımız analizde, iletim hattı kaybının, iletim hattı karakteristik empedansını, Zı_{me}, gerçel sayı olarak kabul etmemizi engellemeyecek kadar düşük olduğunu kabul ettik. Kaynak ve yük yansıma katsayıları bu empedansa göre tanımladığında:

$$I_{g} = \frac{Z_{hne}}{Z_{g} + Z_{hne}}$$
(1)

ve

$$\Gamma_L = \frac{ZL - Z_{n_{oo}}}{Z_L + Z_{hae}}$$
(2)

olmaktadır, a iletim hattının zayıflatma faktörünü göstermek üzere, kayıp faktörü, L:

 $L = e^{2at}$ olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, bu iletim hattının, Z, yüküne aktaracağı gürültü gücü şöyledir:

$$l = kTAf \frac{\left| \Gamma_L \right|^2}{\left| 1 - \Gamma_L \Gamma_g \right| L \left| L \right|^2 L} \left(r_L - \left| \Gamma_g \right|^2 / L - 1 + \left| \Gamma_g \right|^2 \right)$$
(4)

Yük empedansı, çıkış empedansının eşleniği olduğu durumda aktarılan güç, en fazla aktarılabilecek güce esit olduğundan, kayıplı bir iletim hattının aktarabileceği en fazla gürültü gücü söyledir:





ŞEKİL 1. Eşdeğer hat uzunluğunun kaynak yansıma katsayısı ile değişimi

$$P_{n,\max} = kT\Delta f \frac{/. - |\mathbf{r}_{s}|^{2} / /, -1 + |\mathbf{r}_{s}|^{2}}{(1 - |\mathbf{r}_{s}|^{2})L}$$
(5)

Bu eşitlik incelendiğinde görülen odur ki, gürültü gücü kaynak yansıma katsayısının mutlak büyüklüğü ile artmakta ve yansıma en yüksek değerine ulaştığında:

$$P_{n,\max} = kT\Delta f \tag{6}$$

olmaktadır. Bu gürültü, bir direncin aktarabileceği en fazla güce karşılık geldiğinden, uygun tasarlanmamış bir iletim hattının ne kadar çok gürültü yaratabileceği görülmektedir.

Bu analiz, besleme yapılarındaki farklı elemanların gürültü katkılarını veren, besleme yapısının genel gürültü değerlendirmesinde kullanılacak olan, bir 'eşdeğer hat uzunluğu' tanımında kullanılmıştır. Bu parametrenin kullanıldığı uygulamalar ileriki bölümlerde verilmektedir.

L, uzunluğu *P.*, kaynak yansıma katsayısı r_g olan incelenen iletim hattının kayıp faktörü olsun. Bu durumda aktarabileceği gürültü gücü (5)'de verildiği gibidir. Ln[^] aynı- kayıp özeliklerine sahip, *f* reqv uzunluğunda, kaynak yansıma katsayısı sıfır olan bir iletim hattı olsun. Bu hattın aktarabileceği gürültü:

$$P_{eqv} = kT\Delta f \stackrel{f}{\xrightarrow{-1}} \frac{-1}{L_{neqv}} \qquad 7 \qquad)$$

olacaktır. İncelenen hattın, gürültü özelliklerini bu eşdeğer hat ile gösterelim. L[^], P|,ne-Peqv olacak biçimde seçildiğinde her iki hat da aynı gürültü gücünü yaratacaktır. Bu durumda:

$$L_{neqv} = \frac{\left| f_{s} - |\mathbf{r}_{s}|^{2} \right|^{2}}{\left(L^{2} - |\mathbf{r}_{ss}|^{2} \right) - \left(L - 1 \right) \left(L + |\mathbf{r}_{s}|^{2} \right)}$$
(8)



ŞEKİL 2. Güç birleştiricinin şematik gösterimi

$$\frac{1}{2a} \cdot \ln \left(\frac{L^2 - |\Gamma_g|^2}{\left(L^2 - |\Gamma_g|^2 \right) - (L - 1)\left(t + r \right) |_{y}^2} \right)$$
(9)

olacaktır. Bu **U** 'eşdeğer 'hat uzunluğu' gürültü sıcaklığının bulunmasında doğrudan kullanılmaktadır. Eşdeğer hat uzunluğu fiziksel uzunluk birimi ile ifade edilmekte ve en az değeri hattın fiziksel uzunluğuna eşit olmaktadır. Bu biçimde gürültü sıcaklığını hesaplamadan gürültünün yansıma katsayısından kaynaklanan artışı belirlenebilir, farklı özellikteki iletim hatları gürültü bakımından karşılaştırabilir. Şekil 1'de fiziksel uzunluk ile normalize edilmiş olarak, gürültü eşdeğer uzunluğunun yansıma katsayısı ile değişimi verilmiştir.

Bir anten dizisi besleme yapısı güç birleştiriciler, Şekil 2, kullanılarak tanımlanabileceğinden, bu yapıların analizi, anten dizisi besleme yapılarının gürültü analizine temel oluşturmaktadır. Güç birleştirici yapıların analizinden görülebileceği gibi faz ilintili gelen işaretler yansımaya uğramadan eklenmekte, bu nedenle giriş kapılarından alınan toplam güç çıkış kapısına aktarabilmektedir. Sadece faz ilintili durum için uyumlanmış olan bu yapılar, aralarında faz ilintisi olmadan gelen işaretler için, giriş empedans uyumu olmadığından, yansıma yaratmakta ve gelen güç ancak güç birleştirici kollarının birleştirme oranı kadar çıkışa aktarabilmektedir. $\pounds ew.i$ ^{ve} ^eqv; eşdeğer uzunluğunda iki kolu olan bir birleştirici, kollar arasındaki birleştirme oranı 1:p² olduğunda:

$$\ell_{comb} \approx \frac{1}{1+p^2} \ell_{cop,1} + \frac{p^2}{1+p^2} \ell_{cop,2}$$
(10)

eşdeğer hat uzunluğuna sahip olacaktır. Kollar aynı özelliklere sahipse, yani *C* eqv= *f*- eqv, 1[⁼] 'eqv2İse:

^comb ~(· eqv O¹) olacaktır. Anten dizisi besleme yapısı içinde arka arkaya bağlanmış olan güç birleştiricilerin birleştirme oranları çarpılarak bulunacak olan bir ağırlık katsayısı, w, bu birleştiricilerin önüne bağlanmış olan

ELEKTRIK, ELEKTRONIK, BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI 7. ULUSAL KONGRESI

ve

bir yapının ya da anten elemanının, çıkışa aktarabileceği gürültü gücünün bulunmasında çarpan olarak kullanılacaktır. Gürültü gücünün takip eden kayıplı yapılarda belli bir kayıp faktörü ile, L[^], zayıflayacağı da dikkate alındığında, çıkışa aktarılan güç:

$$P \qquad -ujy \frac{1}{L_{nm}} \times P_{lone} \qquad (11)$$

olacaktır. Buna ilişkin olarak tanımlanacak bir ağırlıklı eşdeğer hat uzunluğu, " E_{max} :

$$*l_{mqv} = \frac{1}{2\alpha} \ln \left[\frac{L^{2-} |\Gamma_g|^2}{\left(L^{2-} |\Gamma_g|^2 \right) - \frac{w}{L_{prv}} \left(L - l \right) \left(L + |\Gamma_g|^2 \right)} \right]$$
(12)

olacaktır.

3. ANTEN BESLEME DİZİSİ GÜRÜLTÜ SICAKLIĞI

Anten besleme dizisinin gürültü sıcaklığının bulunmasında ağırlıklı eşdeğer hat uzunluğu tanımı kullanılmıştır. 2xp elemanlı bir paralel anten dizisinin eşdeğer hat uzunluğu, _H, <u>1</u>* p <u> $Z_{arr} = \frac{z - \langle tk \rangle - Z'_{w} + k}{Z_{arr} + Z_{lore,k}}$ </u>

ve $\pounds_{mk} = i/2^{nk}$ olmak üzere:

$$l_{p} = \frac{1}{2\alpha} \sum_{k=1}^{p/2-1} \ln \left(\frac{L^{2} - |\Gamma_{g,k}|^{2}}{L^{2} - |\Gamma_{g,k}|^{2} - \frac{w}{L_{prv,k}} (L-1) (L + |\Gamma_{g,k}|^{2})} \right)$$
(13)

olarak bulunmaktadır. Bu tip yapılarda besleme katsayılarını değistirmemek icin, anten elemanları arasına empedans dönüştürücüler bağlanamamakta, paralel bunun sonucunda bağlanan anten empedansları uyumlaması oldukça güç empedans seviyeleri yaratmaktadır. Eleman sayısı arttıkça artan bu empedans uyumsuzluğu oldukça hızlı artan bir gürültü sıcaklığı yaratmaktadır. Corporate besleme yapılarında böyle bir sorun olmadığından, fiziksel hat uzunluğu daha fazla da olsa, eşdeğer hat uzunluğu daha kısa çıkabilmektedir. Faz ilintili ve ilintisiz durumlar için empedans uyumlu olan N=2ⁿ elemanlı bir corporate besleme yapısının eşdeğer hat uzunluğu:

$$I_{n,even} \approx \sum_{k=1}^{n/2} \lambda \cdot 2^{k-1} - \lambda / 4$$

= A.-2"" - 5/4-A. (14)
n.odd $I_{n-1} + 1/2 \cdot \lambda \cdot 2^{(n-1)/2}$

olarak bulunmaktadır.



ŞEKİL 3. corporate besleme yapısı şematik gösterimi

4. AKTIF ANTEN DIZILERINDE GÜRÜLTÜ

Alıcı antenlerde gürültü performansı kazanç gürültü sıcaklığı oranı (G/T) ile ölcülmektedir. Alıcı anten dizilerinin yüksek kazanclı ve düşük gürültülü olması için aktif eleman kullanılarak aktif anten dizisi haline getirilmesi başarılı sonuçlar vermektedir [5], Alıcı sistemlerde pasif bir anten dizisinin cıkışına düşük gürültülü yükselteç (LNA) bağlanması gereklidir. Ancak, anten dizisine LNA bağlanması, gürültü faktörüne bağlı olmadan, anten sisteminin gürültü sıcaklığını artırır. Çıkışına LNA bağlanmış bir anten dizisini, anten dizisi içerisine dağınık olarak yükselteç bağlanarak aktif hale getirilmiş bir anten dizisi ile karşılaştırdığımızda ise görürüz ki, yükselteçler anten elemanlarına ne kadar yakın konulursa gürültü faktöründeki iyileşme o kadar artar. Hatta, bazı durumlarda pasif antenin G/T oranından daha yüksek oranlar elde edilebilir.

Şekil 3'teki gibi bir *corporate* besleme yapısını göz önüne alalım. r besleme yapısının verimliliğini, T_A anten elemanının gürültü sıcaklığını, $J_u^{}$ yükseltecin gürültü sıcaklığını, T_c besleme yapısının gürültü sıcaklığını, G yükseltecin kazancını göstermek üzere, sadece çıkışa yükselteç bağlandığında, gürültü gücü:

$$P_{tek} = k\Delta f \left(\left(\eta T_A + T_{TNA} \right) + T_T \right) \cdot G$$
 (15)

olacaktır. Yükselteçler çıkıştan önceki bir seviyeye bağlandığında ise, Tr=T₁xi'i2'T2 ve rp r),x r^ olmak üzere, n,, ve Ti yükselteç öncesindeki, i]- ve T yükselteç sonrasındaki besleme yapısının verimlilik ve gürültü sıcaklığını gösterdiğinde gürültü gücü:

$$P_{dagunk} = k\Delta f \left(G \eta_2 \left(\eta_1 T_A + T_1 + T_{LNA} \right) + T_2 \right)$$
 (16)

olacaktır. (15) ve (16)'nın karşılaştırmasından, yükselteçlerin anten dizisi besleme yapısında dağınık olarak yerleştirildiğinde daha yüksek bir G/T oranına ulaşıldığı görülmektedir. (16), pasif anten dizisi gürültü sıcaklığı ile karşılaştırıldığında ise:

$$T_2\left(1-\frac{1}{G}\right) - \eta_2 T_{N,i} > 0$$
(17)

olduğu durumda yükselteçlerin dağınık olarak besleme yapısına yerleştirilmesi, pasif anten

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ



.

dizisinden daha yüksek bir G/T oranı oluşturur. Görüldüğü gibi, anten besleme yapısında kullanılan iletim hatlarının kayıp faktörü arttığında ya da kullanılan anten elemanı sayısı artması sonucunda iletim hattı uzunluğu arttığında, düşük gürültü faktörlü yüksek kazançlı yükselteçler kullanmak anten dizisinin gürültü performansını iyileştirecektir.

5. TASARIM ÖRNEĞİ

Bu calısmada güsterilmis olduğu gibi anten dizisi besleme vapisinin faz ilintili isaretler icin empedans uyumlu tasarlandığı gibi yapı icinden kaynaklanan gürültü gibi faz ilintisi olmayan isaretler icin de empedans uyumlu tasarlanması gerekmektedir. Böyle bir tasarım calışmasında 4x8 corporate beslenmiş pasif bir anten dizisinde sadece besleme dizisinde kullanılan iletim hatlarının karakteristik empedansları değiştirilerek gürültü sıcaklığı yarıya indirilmiştir. Aşağıdaki örnekte 16x16 bir pasif anten dizisi tasarlanmıs ve farklı seviyelere yükseltecler bağlanarak gürültü sıcaklıkları hesaplanmıştır.

RT-DUROID 5880 substrat üzerinde mikroserit dikdörtgen yama anten tasarlanmıştır. Antenlerin giriş empedansı 10 GHz'te 276LI dur. 256 anten corporate dağılımlı düzgün besleme yapısında olarak beslenerek alıcı bir anten dizisi haline getirilmiştir. Anten elemanları arasındaki fiziksel mesafe ısınım örüntüsü özelliklerine göre seçilmiştir. Çeyrek dalga boyu iletim hatları kullanılarak empedans dönüşümleri yapılmış ve besleme yapısı hem faz ilintili hem de faz ilintili olmayan isaretler için empedans uyumlu hale getirilmiştir. Bu besleme yapısının toplam eşdeğer uzunluğu, çevre sıcaklığı 290°K olduğu durumda T=101°K karşılık gelmek üzere 14.8 Â. olarak hesaplanmıstır.

Mikroserit empedans uyumlama elemanları ve ultra düşük gürültü faktörlü bir pHEMT, NEC 32484A, kullanılarak bir yükseltec tasarlanmıştır. Yükseltecin 10GHz'teki gürültü faktörü 0.6dB, kazancı ise 14dB olarak kullanılan hesaplanmıştır. Uyumlamada devrelerin antenler arasındaki fiziksel alana sığdırılabildiği daha önceki bir calismada gösterilmiştir [5]. Bu yükselteç anten dizisinin çıkışına T=35.6dB-K gürültü bağlandığında sıcaklığı oluşmuştur. Ağırlıklı eşdeğer hat uzunluğu ve aktif anten dizisi gürültü analiz yöntemleri kullanılarak yükselteçler besleme yapısı üzerinde farklı seviyelere bağlandığında edilen gürültü elde sıcaklıkları hesaplanmış ve Tablo 1'de verilmiştir. Bu tablodan görülmektedir açıkça ki yükselteçler anten yaklaştıkça aktif antenin elemanlarına gürültü sıcaklığı düşmektedir. Ayrıca, (17)'nin sağlanma koşulu dikkate alındığında görülmektedir ki bu tasarım örneğinde 7. ya da daha önceki seviyelere yükselteç Dağlandığında aktif anten dizisi pasif antenden daha yüksek bir G/T oranında çalışacaktır.

TABLO 1. 16x16 aktif anten dizisinde yükselteç yerleştirme seviyesine bağlı gürültü sıcaklığı

Seviye	1	2	3	4	5
Yüks. Sayısı	256	128	64	32	16
T (dB-K)	30.7	30.9	31.1	31.7	32.1

Seviye	6	7	8	çıkış
Yüks. Sayısı	8	4	2	1
T (dB-K)	32.9	33.6	34.7	35.6

6. SONUÇ

düşük kayıplı Bu calısmada, iletim hatlarının kullanıldığı anten dizisi besleme yapılarının analizi uzunluğu' verilmis ve 'eşdeğer hat kavramı tanıtılmıştır. Besleme yapıları için faz ilintisi olmayan işaretler için de empedans uyumlamanın önemli olduğu gösterilmiştir.

'Eşdeğer hat uzunluğu' kavramı aktif anten dizilerinin analiz ve tasarımında kullanılmış ve anten dizilerinde yükselteç yerleştirilecek noktaların belirlenmesinde bir tasarım kriteri olarak kullanımı gösterilmiştir. Çok düşük gürültü seviyeli aktif elemanların kullanılmaya başlanması ile birlikte, aktif anten dizilerinin alıcı anten yapılarında kullanılma alanları daha da yaygınlaşacaktır.

KAYNAKÇA:

[1] Y. T. Lo, S. W. Lee and Q.H. Lee, 'Optimization of directivity and signal-to-noise ratio of an arbitrary antenna array', Proc. IEEE, vol. 54, pp. 1033-1045, Aug. 1966.

[2] H. An, B. Nauvelaers, A. van de Capelle, 'Noise figüre measurement of receiving active microstrip antennas', Electron. Lett., vol. 29, no. 18, pp. 1594-1596, Sep. 1993.

[3] M. A. Weiss, 'Microstrip antennas for millimeter waves', IEEE Trans. Antennas Propagat., vol AP-29, pp. 171-176, Jan. 1981.

[4] L.P.Winkler and M. Schwartz, 'A fast numerical method for determining the optimum SNR of an array subject to a Q factor constraint', IEEE Trans. Antennas Propogat., vol. AP-20, pp. 503-505, July 1972.

[5] Ş. Demir, C. Toker and A. Hızal, 'Design of an active microstrip array using a microwave circuit simulator', in Proc. IEEE MTT-S Top. Symp. on Tech. for Wireless Appl., Vancouver, Canada, Feb. 1997. pp. 103-106.



SİMETRİK LC KAFES YAPILI FAZ KAYDIRICILARIN KAYIPLI DURUM ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

Baran TANDER Mahmut ÜN

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektronik Müh. Bölümü 34850 Avcılar İSTANBUL

Abstract:

In this study symmetrical lattice phase shifter circuits with loss are analyzed and designed. Frequency characteristics of the attenuation of the s₂ scattering parameter are sketched in the lossy case for 180^o phase shift of these circuits which are predicted to work in two different states by the use of PIN diodes. The normalized component values of the circuit having loss are optimized with the MATLAB 4.0 program and compared with the results obtained before the optimization. Pspice 5 circuit analysis program is used for the determination of frequency characteristics of the circuits.

Bu teorik çalışmada, haberleşme sistemlerinde kullanılabilecek, PIN diyotlar ile kuplajlanmış simetrik LC kafes yapılı faz kaydırıcıların kayıplı durum analizleri ve optimizasyonları yapılmıştır.

Giriş:

Devre sentezindeki cok klasik ve basit vapılardan olan ve AP filtre özelliği gösteren simetrik LC kafes vapıları gerek cok genis bir frekans bandına sahip olmaları gerekse de tasarım kolaylıkları bakımından faz kaydına devreler için oldukça elverişlidirler. İncelenen devreler PIN diyotlarının iletim veya tıkama yönünde kutuplanmaları (on veya off olmaları) ile 9 ö faz + ve acılarını gerçekleştirebilmektedirler. Sözkonusu devrelerin kayıpsız analizleri daha önceden yapılmıştır [1]. Burada önerilmis olan 3 değisik simetrik LC kafes vapısında, bobinler ve iletim vönünde kutuplanan PIN divotlar icin r gibi bir kayıp direnc, tıkama yönünde kutuplanan PIN diyotlar için de yine aynı değerli r kayıp direncine seri C_p gibi bir kapasite modeli kullanılmıştır. Kayipli halde ve optimizasyon sonrasında simetrik LC kafes yapıları için s, saçılma parametresinin dB cinsinden zayıflama ve fazları coo = 1 normalize karsılastırmıstır. frekansında Ayrıca cesitli açılarda faz kaymaları için 3 tip devrede öngörülen eleman değerleri de bir tablo halinde verilmistir.

Kayıplı Analiz:

Şekil 1'deki gibi simetrik bir kafes devresinin s_{21} parametresinin ifadesi şöyledir [2], [3]:





Şekil 1: Simetrik kafes devresinde gelen ve yansıyan güçler.

Yapılan çalışmada Şekil 2, 3 ve 4' teki kayıplı yapılar gözönüne alınmış ve A ve B durumları için s_{2i} parametreleri yukarıdaki bağırt: yardımıyla hesaplanmıştır.



Şekil 2: (a) Tip I devresi, (b) A konumunda (D, on, D_2 off) eşdeğer devre, (c) B konumunda (D, off, D_2 on) eşdeğer devre.

- ----

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ

323)









Optimizasyon:

Yapılan optimizasyon aslında birkaç tane nonlineer denklemin çözülmesinden ibarettir. Her devre için kayıplı durumdaki s2, parametresinden türetilen genlik ve faz ifadelerinin ideal durumlara eşitlenmesi bize gerekli olan denklemlerin bir kısmını verecektir. Bundan başka gözönüne alinacak bir maliyet fonksiyonu (cost function) bize ek bir kısıtlama daha getirecek ve III devresi için bilinmeyen sayımız denklem sayımıza eşit olacaktır. Tip II devresinde hesaplarda kolaylık olması bakımından C_{D1} ve C_{D2} 0.5 olarak seçilmiş ve optimizasyona dahil edilmemiştir. Tüm yapılar düşünüldüğünde herhangi bir net faz açısı için kayıplı durumda s_{21} parametresi için asağıdaki ideal kosulların sağlanması gerekmektedir:

$$\begin{vmatrix} s_{-3IA} \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} s_{2IB} \end{vmatrix} = 1$$

$$\theta_{2IA} = \angle s_{2IA} = -\theta_n \quad \text{et} \quad 2$$

$$\& 2IB = \sum_{s=2IB}^{s=2IB} = \≠, \quad s \geq 2$$

Bunlardan başka genlik ve faz için iki ayrı maliyet fonksiyonu da tanımlanarak denklen sayısı 6' ya çıkartılacaktır. Maliyet fonksiyonları, hataların karelerinin minimum olması istendiğinden su sekilde tanımlanabilir:

$$(|s_{21,4}| - |s_{21,4}|^2 - 0)$$

 $(\theta_{nel} - |e_{21,4} - e_{21,1}|)^2 = 0$

Görüldüğü üzere yukarıdaki 6 denklemin cözümünden istenen optimize edilmiş normalize eleman değerleri elde edilebilir. Denklemlerin MATLAB cözüm kümesi 4.0 programinin **OPTIMIZATION TOOLBOX' inda yeralan** "fsolve" alt programı ile bulunabilmektedir [4]. Tabii ki tüm bu denklemlerin çözülebilmesi için başlangıç değerlerine ihtiyacımız vardır. Kayıpsız halde eleman değerlerini başlangıç hesaplanan değerleri olarak düşünmemiz çözüme daha hı^lı ve doğru ulaşmamızı sağlayacaktır.

Sonuçlar:

istenen herhangi bir 0 faz kayması $co_0 = 1$ normalize açısal frekansında sabit olarak gerçeklenmektedir. Buna ek olarak devrelerin büyük kayıp dirençlerine sahip olduğu durumlarda bile faz açılarının az değiştiği görülmüştür.

Bu yapıların başka bir avantaji da monolitik olarak gerçeklenebilmeleridir.

Optimum değerler için PSpice 5 devre analiz programıyla analiz edilen frekans

karakteristiklerinde özellikle genliklerde bir iyileşme olduğu gözlenmiştir.

Kayıplı analizi ve optimizasyonu yapılan kafes yapılarının özellikle yüksek frekanslarda çalışan sistemlerde askeri ve ticari amaçlı uygulamalarda (örneğin dizi anten sistemleri gibi) bir faz kaydırma birimi olarak kullanılmasının son derece elverişli olacağı tahmin edilmektedir.

Savisal Bir Örnek:

a > o = 1 Grad / s için - 90°' lik bir simetrik LC kafes yapılı faz kaydırma biriminin eleman değerlerinin hesabı aşağıdaki şekildedir:

Frekans + Empedans normalizasyonu yapılırsa,

$$R = r \cdot R_{n} = 0.02 \cdot 50 = I\Omega$$

$$R_{s} = R_{L} = 50 \ddot{U}$$

$$\theta_{nel} = \langle istenenfaz \ kaymasi \rangle -2 = 90 - 2 = 180^{\circ}$$

$$Tip \ I \ devresi \ O_{net} = 180^{\circ} \quad için$$

$$L_{s} = L_{2} = -\frac{100}{100} = \frac{50 \cdot 1.0394}{W^{2} \cdot n} = 51.97 \quad nH$$

$$C_{m} = C_{or} = \frac{C_{a}}{R_{o} - (o_{o})} = \frac{0.4811}{50 \cdot 10^{5}} = 9.622 \ pF$$

Referanslar:

[1] "New Circuit Topologies To Construct Wide Phase Range, Wide Frequency Band Digital Phase Shifters", M. ÜN, B.S. YARMAN, ECCTD Conferance 1995, İstanbul,

[2] "Electric Circuits 4th Ed." J.W.NILSSON, Addison - Wesley Publishing Comp., 1993, "Electronic **Weasurements** [3] And Instrumentation", B.M.OLIVER, J.M CAGE, McGraw - HIN, 1986,

[4] "MATLAB High Performance Numeric Computation And Visualization Software User's Guide", The MathWorks Inc.









Şekil 9: Tip - III devresi frekans karakieristikleri



Şekil 10: Tip - III devresi frekans karakteristikleri

Tablo 3: $o_0 = 1$ civarında faz açıları:

тір				KAYIPLI	OPTIMIZA	
	One,	DURU	Mu	DURUM	I IV ON	
	f)	M	(rad)	FAZ AÇISI	SOMRASI	
	-/		[f)	0	
1	120	<u> </u>	0.9999	<u>-59</u> 875	-59 845	
	120	В	<u>0.</u> 9999	60 050	60 094	
	180	<u>A</u>	0.9999	-89.986	-89.993	
	180	В	1.0002	<u>89.</u> 973	89 966	
	240	A	0.9999	<u>-119.950</u>	-119.894	
<u> </u>	240	В	0.9999	120.125	120.161	
<u> </u>	120	Α	0.9999	-59.930	-60.363	
	120	В	1.0002	59.363	59.356	
	180	<u> </u>	0.9999	-90.163	-90.453	
<u> </u>	180	В	0.9999	-270.163	-270.453	
	240	A	0.9999	<u>-1</u> 20.587	-120.597	
_!!	240	B	0.9999	-239.930	-240.363	
- 111	_ 120	A	0.9999	-59.955	-60.004	
<u> </u>	120	В	0.9999	60.030	60.002	
	180	A	0.9999	-89.997	-89999	
	180	В	1.0002	89 962	89.960	
	240	Α	0.9999	-119.970	120.002	
	240	В	1.0002	120001	1 <u>19.9</u> 47	

Tablo 1: co, 1 için Normalize Eleman Değerleri Seçim Tablosu

ΤİΡ	One,	<i>L,</i>	L,	C,	C ₂	C ₀₁		r
I		0.5988	1.7928	X	Х	0.8345	0.2778	0.02
1	180"	1.0394	1.0394	X	Х	0 <u>.4811</u>	0.4811	0.02
	240°	1.7965	0.5987	Х	Х	0.2775	08335	0.02
<u> </u>	120"	0.5106	1.046	3.7235	1.4616	0.5	0.5	0.02
	180"	0.7394	0.7394	2.2982	22982	0.5	0.5	0.02
	240"	1.046	0.5106	1.4616	3.7235	0.5	0.5	0.02
	120"	0.5962	1.786	0.7674	0.2779	0.0721	0.002	0.02
	180"	1.0304	1.0304	0.4852	0.4851	0.0002	0.0003	0.02
- 111	240"	1.786	0 5963	0.2779	0.7637	0.002	0.0758	0.02

Tablo 2: co_o = 1 civarında zayıflama değerleri 20logH(j(o)

TİP	^{One,} f)	DURUM	(00 (rad)	KAYIPLI DURUMDA ZAYIFLAMA (mdB)	OPTIMUM ZAYIFLA MA (mdB)	FARK (mdB)
1	120	Ā	0.9999	-345.246	-340.675	4.577
1	120	В	0.9999	-345 659	-340.795	4.864
1	180	A	0.9999	-345 <u>.447</u>	-340.801	4.646
I.,	180	В	1.0002	-347 <u>.575</u>	-340.809	6.766
I	240	A	0.9999	-345.659	-340.767	4.892
	240	В	0.9999	-345.246	-340.766	4.480
, II	120	A	0.9999	-636.018	- <u>688.54</u> 8	-52.530
11	120	В	1.0002	-966.443	-856.788	109.65
II	180	A	0.9999	-854.456	-836.179	18.277
. 11	180	B	0.9999	-854.456	<u>-836.179</u>	18.277
	240	A	0.9999	-967.614	-857.691	109.92
	240	В	0.9999	-636.018	-688.548	-52.530
	120	A	0.9999	-334.706	- <u>2</u> 98.578	36.128
iii	120	В	0.9999	-227 <u>.860</u>	-215.217	12.643
	180	A	0.9999	-282.127	-256.462	25.665
	180	B	1.0002	-282.187	-256.406	25.781
111	240	A	0.9999	-227 860	- <u>215310</u>	12.550
	240	B	1.0002	-335.023	-298.698	36.325

32(

-

- +